

LEDドライバ用
制御 IC

MV2002SG

MV2052SG



アプリケーションノート
Ver. 2.0







MV2002SG / MV2052SG

使用上の注意

このたびは、弊社製品をご使用いただき誠にありがとうございます。

当 IC をご使用の際は、お客様の安全を確保するため下記の警告ならびに注意を必ず守ってご使用下さい。

警告		誤った取り扱いをしたときに死亡や重大な人身事故および大きな物的損害に結びつく危険性のあるもの。
注意		誤った取り扱いをしたときに軽傷に結びつく恐れ、または軽微な物損事故に結びつく恐れのあるもの。

警告		当 IC は、一般電子機器(事務機器・通信機器・計測機器・家電製品等)に使用されることを意図しております。誤動作や事故が直接人体や生命を脅かす恐れのある医療器、航空宇宙機、列車、輸送機器(車載、船舶等)、原子力等の制御機器には使用しないで下さい。一般電子機器以外にご使用になる場合は弊社までご相談下さい。
注意		修理や改造は、重大な事故につながりますので、絶対にやめて下さい。 《感電、破壊、火災、誤動作等の危険があります。》
		異常時は出力端子に過大電圧が発生したり、電圧低下となる場合があります。異常時の、負荷の誤動作や破壊等を想定した保護対策(過電圧保護、過電流保護等の保護対策)を最終機器に組み込んで下さい。
		入力端子、出力端子の極性を確認し誤接続の無いことを確認してから通電して下さい。 《保護素子が切れたり、発煙・発火の原因になります。》
		決められた入力電圧を必ず守っていただくとともに、入力ラインに必ず保護素子を挿入して下さい。 《異常時には発煙・発火の危険があります。》
		使用中に故障または、異常が発生した時は、すぐに入力を遮断して電源を停止させて下さい。また、直ちに弊社にご相談下さい。


●本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。


●御使用頂く際には、仕様書の取り交わしをして頂けます様お願いします。

●ここに記載されたすべての資料は正確かつ信頼し得るものでありますが、これらの資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負いません。

●本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

●本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。

 当社は、品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、誤動作する場合があります。必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご検討下さい。


 本資料に記載されている当社半導体製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。下記の特別用途、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず当社へご連絡の上、確認を得て下さい。

特別用途

輸送機器(車載、船舶等)、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療機器 等

特定用途

原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、生命維持のための装置 等

 なお、IC 製品に関しては、特別用途・特定用途に限らず、連続運転を前提として長期製品寿命を期待される機器、装置にご使用される場合に関しては当社へお問い合わせ下さい。

当社は IC 製品を安全に使っていただくために回路支援をしております。弊社担当営業または商品企画にお問い合わせ下さい。

MV2002SG / MV2052SG

目次

1. 概要	4
1.1 特長	4
1.2 ブロック図	5
1.3 端子配置図	6
1.4 端子機能一覧	6
2. 基本動作の説明	7
2.1 起動シーケンス	8
2.2 レギュレータ機能	9
2.3 リモートコントロール(RC)機能	9
2.4 Alarm 信号出力機能	10
3. 部品選定の手順と設計方法	11
3.1 基本回路構成について	11
3.2 部品選定について	12-13
3.2.1 MOSFET の選定	14
3.2.2 回生ダイオードの選定	14
3.2.3 電流検出抵抗の選定	15
3.2.4 インダクタの選定	15
3.2.5 ゲート駆動回路の選定	16
3.2.6 Svin, Svout 端子の抵抗の選定	16-17
3.2.7 CS 端子フィルタの選定	17
3.2.8 Vcc 端子平滑用コンデンサの選定	17
3.2.9 REF 端子のコンデンサの選定	17
3.2.10 Svin 端子のコンデンサの選定	17
3.2.11 共振コンデンサの選定	17
3.2.12 入力コンデンサ、出力コンデンサの選定	18
3.2.13 Svout 端子のコンデンサの選定	18-19
3.3 補助巻線使用タイプについて	20
3.3.1 補助巻線使用タイプ回路構成	20
3.3.2 補助巻線の選定	20
3.3.3 補助巻線整流用ダイオードの選定	20-21
3.3.4 補助巻線を利用した LED オープン保護	21

MV2002SG / MV2052SG

4. パターン設計上の注意	22
4.1 注意事項	22
4.2 基板パターン例	23
5. 調光特性について	24
5.1 各モードの動作	25
5.1.1 [A]周波数変調領域	25
5.1.2 [B]オフ時間変調領域	26-27
5.1.3 [C]発振停止領域	28
5.2 PWM 調光について	29
5.2.1 100%調光と発振停止領域での PWM 調光	29
5.2.2 リニア調光と PWM 調光の組み合わせ	30
5.3 調光回路	31
5.3.1 PWM 信号を平滑する調光回路例	31
6. アブノーマル時の動作について	32
6.1 LED オープン	32
6.2 LED ショート	32
6.3 異常発熱	33
6.4 CS 端子オープン	33
6.5 CS-GND 端子ショート	33
6.6 電流検出抵抗オープン	33
6.7 電流検出抵抗ショート	33
7. 標準回路例	34
7.1 電源仕様および回路図	34
7.2 電源特性	35
7.3 動作波形例	36

MV2002SG / MV2052SG

1.概要

1.1 特長

MV2002SG / MV2052SG は、外部からの電源供給により低圧ピンのみで構成を可能とした LED 照明用 2ch ドライバー IC です。1 つの制御 IC で 2ch の電流を制御し良好な電流相対精度を得られるため、安定した色の再現が実現できます。

補助巻線なしで擬似共振動作による電流臨界制御が可能のため、シンプルな電源構成で高効率・低ノイズを実現できます。

一般的な電流臨界制御は、調光率の低下とともにスイッチング周波数が上昇するため、スイッチング損失の増加や調光下限値の制限といった欠点があります。MV2002SG / MV2052SG では、調光率が低下すると電流臨界動作から電流不連続動作へ自動的に切り替わるため、スイッチング周波数の上昇を抑制し、スイッチング損失の低減とフリッカのない滑らかな深調光を実現できます。

また、RC 端子電圧もしくは調光端子電圧 (REF1, REF2) をしきい値電圧以上以下にすることで、発振 ON/OFF 制御が可能です。

外部マイコン用電源を内蔵しているため、3 端子 Reg 等を使わずにマイコン電圧を供給することが可能です。

(MV2002SG:3.3V 、MV2052SG:5V)

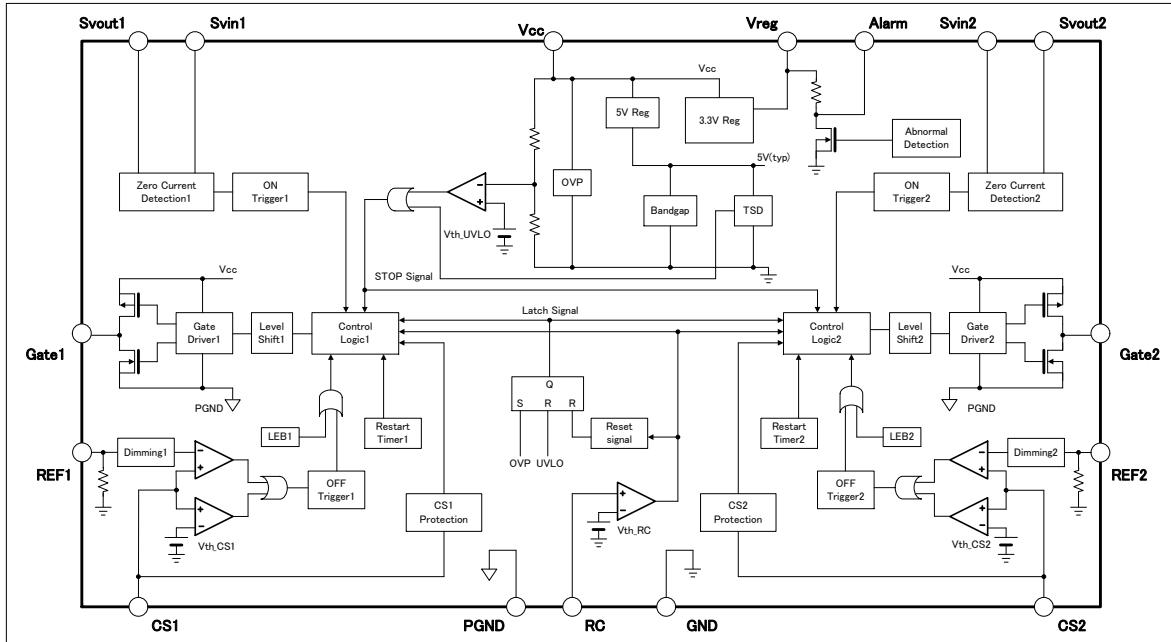
MV2002SG / MV2052SG の主な特長は以下となります。

- 各 CH の電流相対精度が良好なため、調光時における色温度が安定
- 補助巻線なしでの擬似共振動作が可能
- 電流臨界制御による擬似共振動作で、入力変動が小さく高効率・低ノイズ
- オフ時間変調により深調光が可能 (1%以下)
- PWM 調光およびリニア調光が可能
- RC 端子および調光端子 (REF1, REF2) での発振 ON/OFF 制御が可能
($V_{RC} > V_{th_RC_st}$ & $V_{REF} > V_{th_REF_st}$ で発振開始)
- 外部マイコン用電源内蔵 (MV2002SG:3.3V 、MV2052SG:5V)
- 異常動作を検出して Alarm 信号を出力
- 補助巻線を利用した LED オープン保護が可能
- 過熱保護・UVLO・LED ショート保護機能内蔵
- 外部起動回路を利用し、低圧ピンのみで構成可能

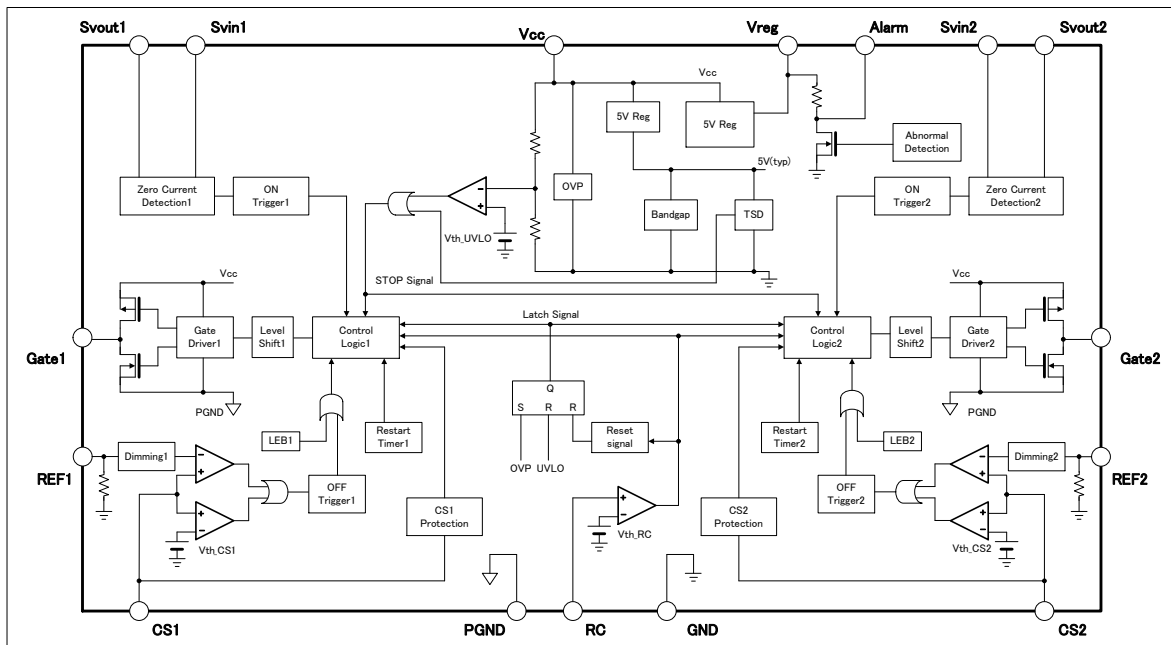
MV2002SG / MV2052SG

1.2 ブロック図

●MV2002SG

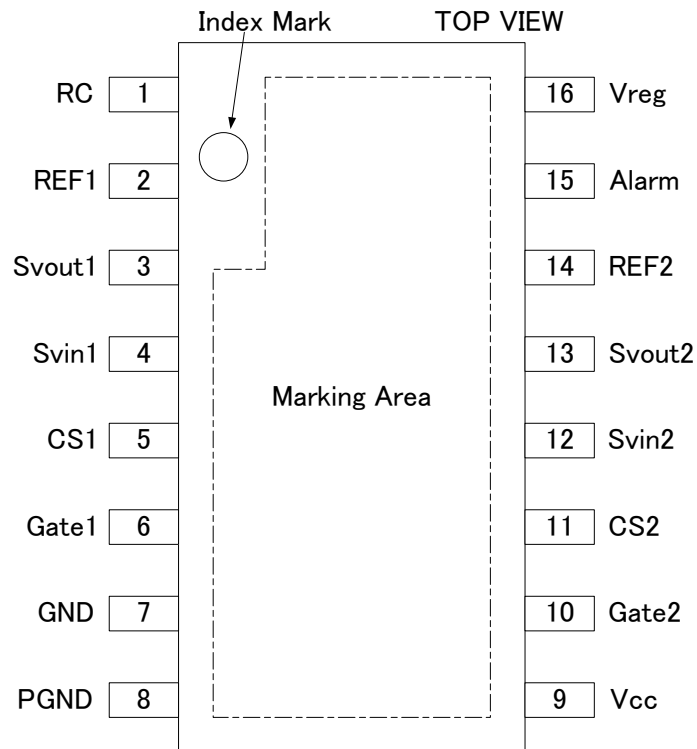


●MV2052SG



MV2002SG / MV2052SG

1.3 端子配置図



Package : SOP16

1.4 端子機能一覧

端子番号	記号	端子名	端子番号	記号	端子名
1	RC	リモートコントロール端子	9	Vcc	IC 電源端子
2	REF1	CH1 調光端子	10	Gate2	CH2 MOSFET 駆動端子
3	Svout1	CH1 ゼロ電流検出端子	11	CS2	CH2 電流検出端子
4	Svin1	CH1 ゼロ電流基準端子	12	Svin2	CH2 ゼロ電流基準端子
5	CS1	CH1 電流検出端子	13	Svout2	CH2 ゼロ電流検出端子
6	Gate1	CH1 MOSFET 駆動端子	14	REF2	CH2 調光端子
7	GND	グラウンド端子	15	Alarm	アラーム送出端子
8	PGND	パワーグラウンド端子	16	Vreg	外部電源端子

MV2002SG / MV2052SG

2.基本動作の説明

MV2002SG / MV2052SG は電流臨界型降圧チョップ方式の制御 IC であり、回路構成は図 1、MOSFET およびダイオードに流れる電流波形はそれぞれ図 2 の I_d, I_F となります。一般的な電流臨界型降圧チョップ回路は I_F がゼロになってから MOSFET がオンするため、ダイオードのリカバリ電流がほとんどなく、PWM 型回路に比べて低損失・低ノイズになります。その一方で、出力電流(LED 電流)の変化にともない発振周波数が大きく変化し、調光特性・効率が悪化するのが欠点です。

MV2002SG / MV2052SG は、電圧変換された I_d を電流検出端子(CS 端子)で検出し、CS 基準電圧に達すると MOSFET をオフします(ピーク電流検出)。また、ダイオード電流 I_F がゼロになり S_{vout} 電圧が S_{vin} 電圧を下回ったことを検出(ゼロ電流検出)し、MOSFET をオンさせて電流臨界制御を行います。チョーク両端の電圧(図 2 の①と②)を抵抗分圧し S_{vin} 端子・ S_{vout} 端子に入力することで、補助巻線なしで電流臨界制御を実現できます。さらに、オフ時間変調機能により、調光時の周波数上昇を抑制することができ、深調光時にも安定した効率・調光特性を得ることができます。(P.22 5 項【調光特性について】参照)

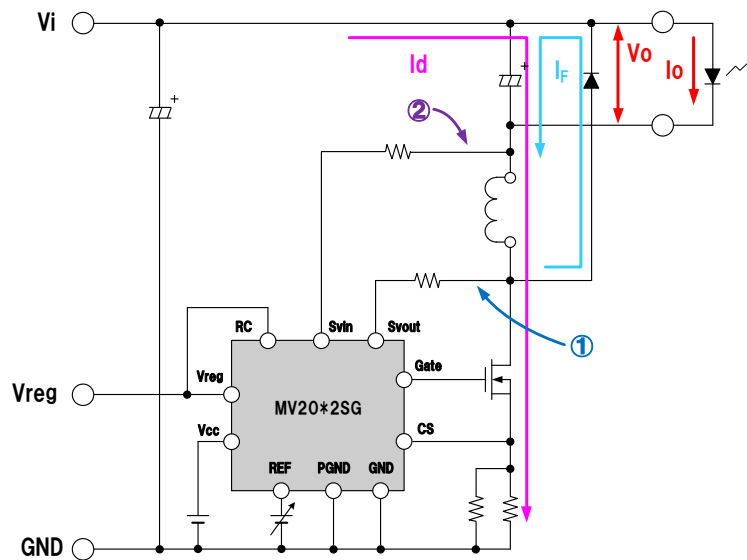


図 1 電流臨界型降圧チョップ回路

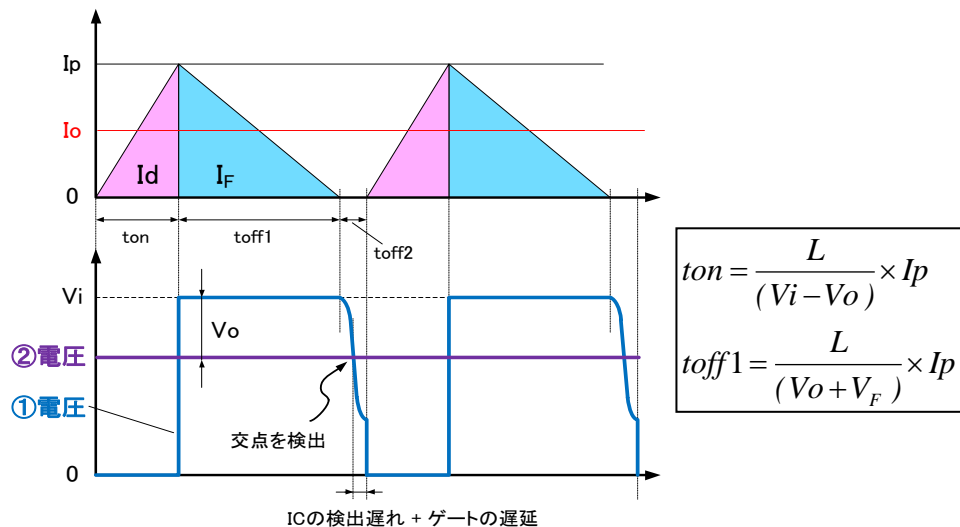


図 2 電流臨界型降圧チョップにおける MOSFET とダイオードの電流波形およびチョーク両端の電圧波形

MV2002SG / MV2052SG

2.1 起動シーケンス

MV2002SG / MV2052SG は、Vcc 端子に動作開始電圧 (V_{cc_start}) 以上の電圧を外部より供給することで、IC 内部のロジック回路が動作を開始します。REF 端子へ印加する信号は、安定動作のため極力 Vcc 電圧が V_{cc_start} 以上になっている状態で印加するようにしてください。なお、マイコン用電源 Vreg 電圧は、Vcc 電圧が投入されると既定の電圧 (MV2002SG: 3.3V、MV2052SG: 5V) を出力します。

図 1 の回路構成にて起動した際のシーケンス例を、図 3 に示します。

通常の起動動作は、RC 端子電圧 V_{RC} が発振開始 RC 端子しきい値電圧 ($V_{th_RC_st}$) 以上かつ Vcc 電圧が V_{cc_start} 以上になった上で、VREF が発振開始 REF 端子しきい値電圧 ($V_{th_REF_st}$) 以上になると、発振を開始します。発振開始により、出力電圧が上昇することで Svin 電圧と Svout 電圧が交差するため、ゼロ電流検出ができるようになります。(図 3(a) 起動動作 OK)

一方、ゲート抵抗値 R13 (R23) が大きい場合や LED と並列に接続するダミー抵抗が小さい場合など出力コンデンサが充電されにくい条件では、発振開始後も出力電圧が上昇せずにゼロ電流検出ができなくなることがあります。ゼロ電流検出ができなくなると通常のピーク電流検出ではなく、強制的に最小オン時間とリスタート時間で動作するリスタート動作となります。ゼロ電流検出ができるまでリスタート動作を継続するため、リスタート動作で出力電圧が上昇していかないと起動できません。(図 3(b) 起動動作 NG) 実機にて起動時の Svin 電圧と Svout 電圧を測定し、ゼロ電流検出ができていないことを必ず確認してください。

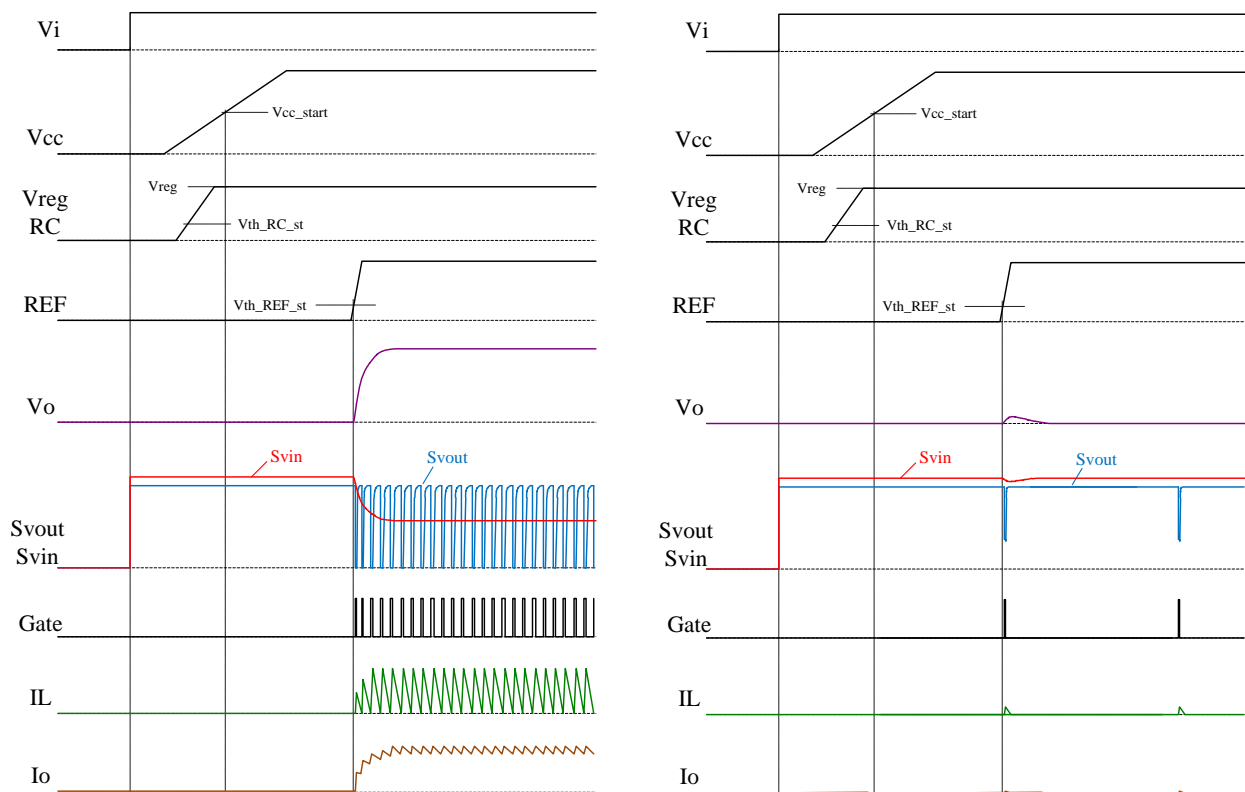


図 3 起動シーケンス例

MV2002SG / MV2052SG

2.2 レギュレータ機能

MV2002SG / MV2052SG はマイコンなどの外部回路に使えるレギュレータ電源回路を内蔵しています。レギュレータ電圧 V_{reg} は、 V_{cc} 電圧が印加されると設定電圧が出力されます(MV2002SG は 3.3V、MV2052SG は 5V)。内蔵レギュレータ回路には垂下型の過電流保護が内蔵されており、レギュレータ負荷電流 I_{reg} が垂下点以上の大きな電流が流れるとレギュレータ電圧を低下させます。レギュレータ特性の例を図 4 に示します。

また、レギュレータ電圧が、動作開始電圧からヒステリシス電圧を引いた電圧 ($V_{reg_start} - V_{reg_hys}$) 以下になると、Gate1、Gate2 の発振を停止します。 V_{reg} が動作開始電圧 (V_{reg_start}) 以上に再上昇すると、自動的に Gate 発振を復帰させます。起動時において、 V_{cc} 電圧が V_{cc_start} に達する前に V_{reg} 電圧が V_{reg_start} に達するように、あまり大きなコンデンサ容量は接続しないようにしてください。(0.1 μ F 程度)

なお、他の機能によって Gate 発振が停止した場合においてもレギュレータ回路は停止しないため、 V_{reg} 端子に接続している外部回路を安定して動作させることができます。

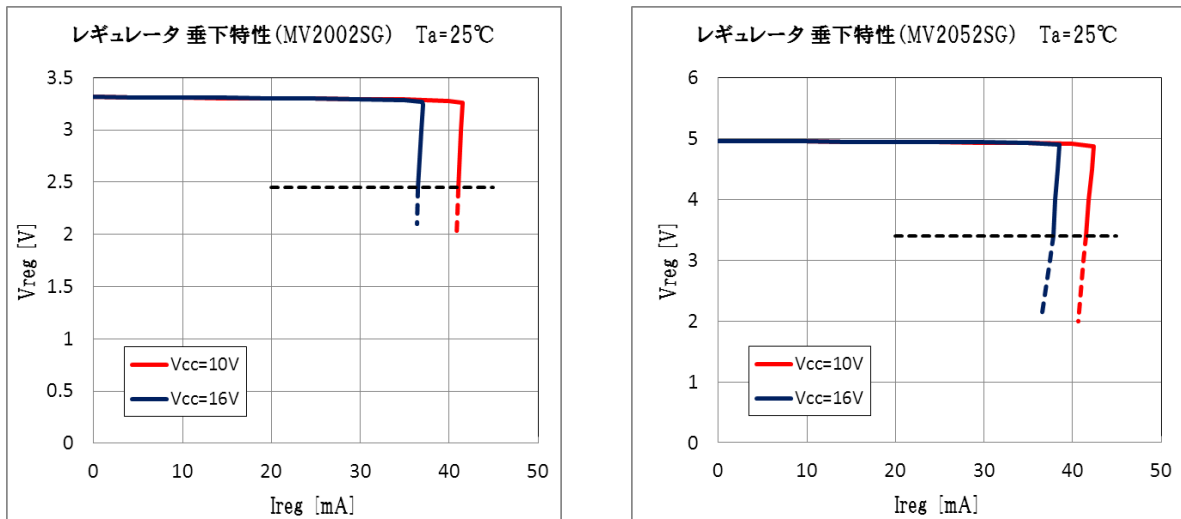


図 4 レギュレータ垂下特性の例

2.3 リモートコントロール(RC)機能

MV2002SG / MV2052SG は外部信号を RC 端子に印加することで、2ch 同時に Gate 発振の ON/OFF を制御することができます。RC 端子電圧 V_{RC} を発振開始 RC 端子しきい値電圧 ($V_{th_RC_st}$) 以上にすることで発振開始し、 $V_{th_RC_st}$ からヒステリシス電圧 ($V_{th_RC_hys}$) だけ下げることによって発振を停止することができます。なお、RC 機能で Gate 発振を停止させた場合でも、レギュレータ回路は動作し続けます。

RC 端子は IC 内部でプルダウンしているため、発振開始させるには V_{reg} 端子に接続するか外部電圧を印加してください。外部電圧を印加する場合は、RC 端子の絶対最大定格を超えないように気を付けてください。

V_{RC} を再印加することより、保護機能によるラッチ停止を解除することができます。(保護機能については、2.4 Alarm 信号出力機能を参照ください)

RC 端子によるリモートコントロールを行う場合は、ノイズによる誤動作を防ぐため RC 端子と GND 端子間にコンデンサ (1000pF 程度) を接続してください。

MV2002SG / MV2052SG

2.4 Alarm 信号出力機能

MV2002SG / MV2052SG は異常動作を検出した際に、外部へ信号を出力する Alarm 信号出力機能を内蔵しております。この機能を使用することにより片 CH での異常時において、Alarm 信号を受けてマイコン等で制御することで別の CH を安全に停止することができます。

Alarm 信号は、Vcc_OVP や CS オープンや Ton_max が 128 回続いたこと (CS-GND ショートなど) を検出すると出力されます。出力される Alarm 信号の電圧値は、Vreg 電圧と等しくなります (MV2002SG: 3.3V、MV2052SG: 5V)。主な異常時の Alarm 信号出力については、表 1 を参照ください。

Alarm 信号の解除は、RC 端子および Vcc 端子でリセットできます。また、Ton_max が 128 回続いたことによる Alarm 信号出力においては、Vcs が基準電圧に達する (ピーク電流検出する) と自動的に Alarm 信号を解除します。

なお、起動時や瞬停時などにおいて、入力電圧と出力電圧の差が小さくなり Ton_max が 128 回続いた場合でも、Alarm 信号は出力されます。このような場合において Alarm 信号が一定期間だけ出力されたとしても、電源として問題がないようにマイコン等の制御で調整してください。

表 1 主な異常時の Alarm 信号出力 (CH1 側異常の場合)

異常動作	CH1	CH2	Alarm信号	復帰方法
Vcc_OVP	発振停止 (ラッチ停止)		○	Vcc or RC リセット
CS端子オープン	発振停止 (ラッチ停止)	通常動作	○	Vcc or RC リセット
CS-GND端子ショート	Ton_max ⇔ Toff_max	通常動作	○	自動復帰
LEDショート	Ton_min ⇔ Trestart	通常動作	×	自動復帰
LEDオープン (基本回路構成時)	Ton_max ⇔ Toff_max	通常動作	○	自動復帰
TSD	発振停止		×	自動復帰

MV2002SG / MV2052SG

3. 部品選定の手順と設計方法

計算はあくまでも概算であり、実際の回路では個々の部品の特性や IC の検出遅れなどの影響により誤差が発生します。実機でのご確認のうえ調整してください。

またオシロスコープにて波形検証する場合は、プローブの容量成分により波形や特性が変化しますので、注意してください。Svin 端子、Svout 端子、CS 端子、MOSFET の D-S 間を測定する際は特に注意してください。

なお、本資料に記載する数値については、特に指定がない場合は TYP 値を使用しています。

3.1 基本回路構成について

MV2002SG / MV2052SG の基本回路構成を図 5、動作波形を図 6 に示します。

図 5 の回路では、チョーク両端電圧の検出により補助巻線が不要になり、回路構成がシンプルになり低コストで構成できます。

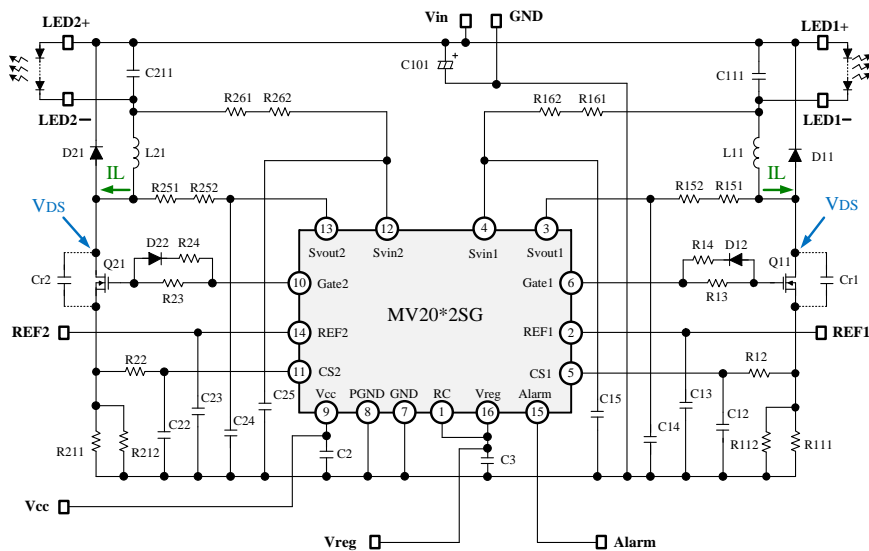
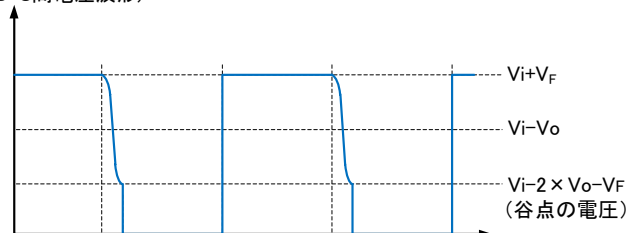
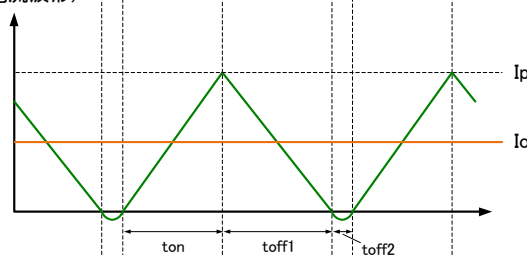


図 5 基本回路構成

V_{DS} (MOSFETのD-S間電圧波形)



IL (チョークコイルの電流波形)



$$\text{ton} = \frac{L}{(V_i - V_o)} \times I_p$$

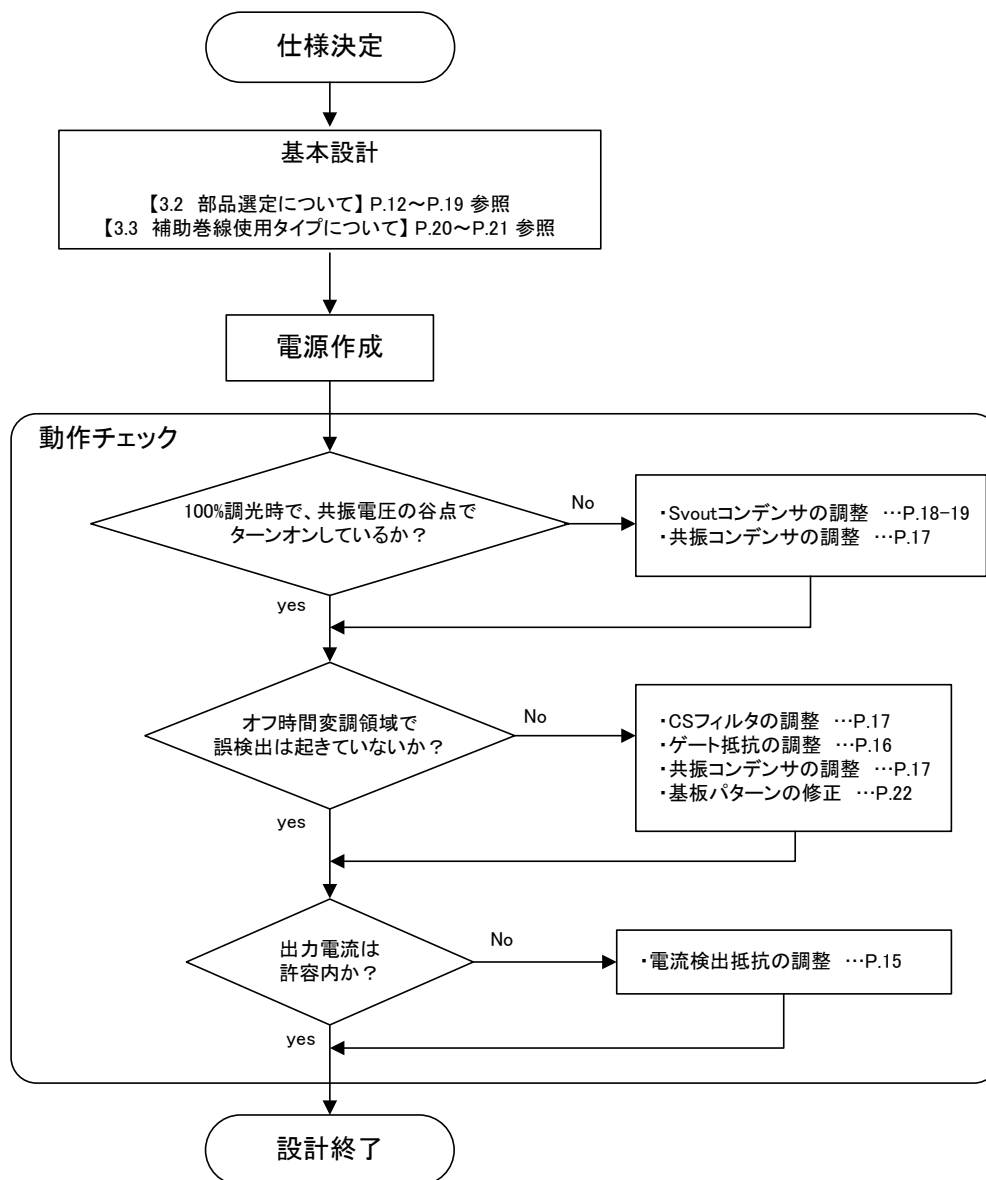
$$\text{toff1} = \frac{L}{(V_o + V_F)} \times I_p$$

図 6 基本動作波形

MV2002SG / MV2052SG

3.2 部品選定について

仕様決定から調整までの設計手順例を以下に示します。本項の設計方法は、電気的な設計方法の一例です。
必要に応じて公的機関の定める安全基準や貴社内規に沿って設計してください。



※設計終了後に部品定数を変更した際には、再度動作チェックを行ってください。

MV2002SG / MV2052SG

・基本設計の注意点

基板パターンや仕様、周辺定数などにより、MOSFETのターンオフ直後に内部電圧やしきい値が変動してしまうことがあります。MV2002SG/MV2052SGは2CHドライバであるため、一方のチャンネル(CH)のターンオフによるしきい値変動などの影響をもう一方が受けてしまう場合があります。そうした場合、オンオフ検出点がズれることでオン時間が変動し、出力電流が変動する可能性があります。2つのCHがほぼ同じスイッチング周波数で動作している場合、オン時間の変動が継続しやすくなり(同期)、出力電流変動が数mA程度になることもあります。(図7)

同期による出力電流変動を軽減するには、パターン設計によりCH間のノイズ干渉を抑えたいうえで、同期期間を短くさせる周辺定数設計が有効になります。具体的には、CH1とCH2で定格電流値のスイッチング周波数に1:1.7程度の差を付けるようにチョークコイルのL値を設計すること(図8)やREFリプル電圧に差を設けること(図9)でターンオフタイミングをズらすことが効果的になります。これらの定数を調整する際、調光特性の動作切り替わりポイントなどの実機動作を確認し調整してください。

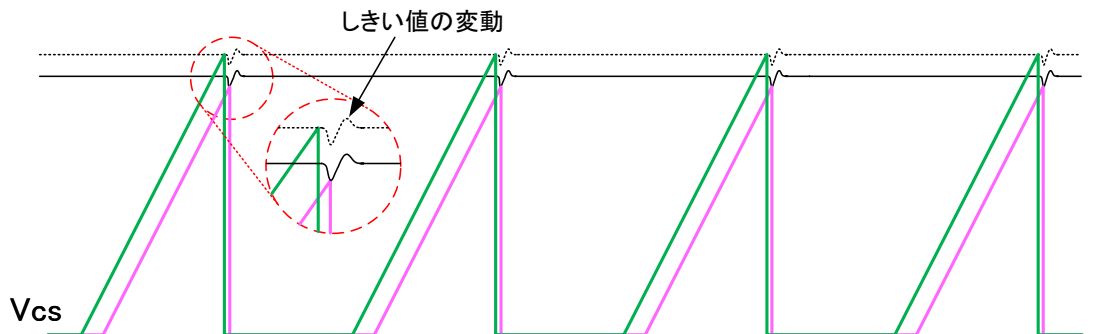


図7 同期時の動作イメージ図

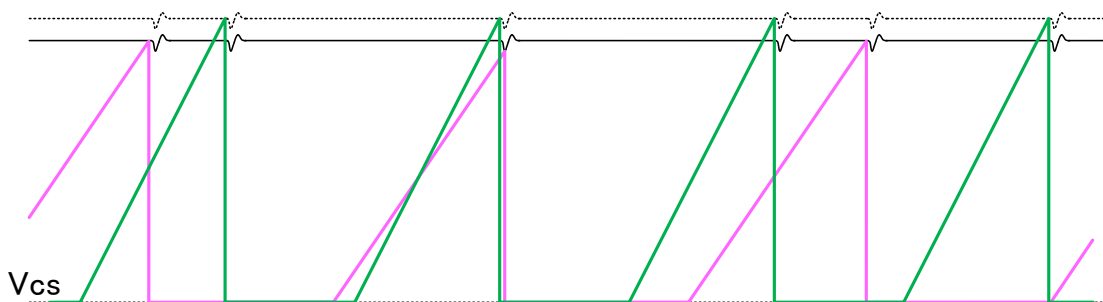


図8 スwitching周波数に差を付けた時の動作イメージ図

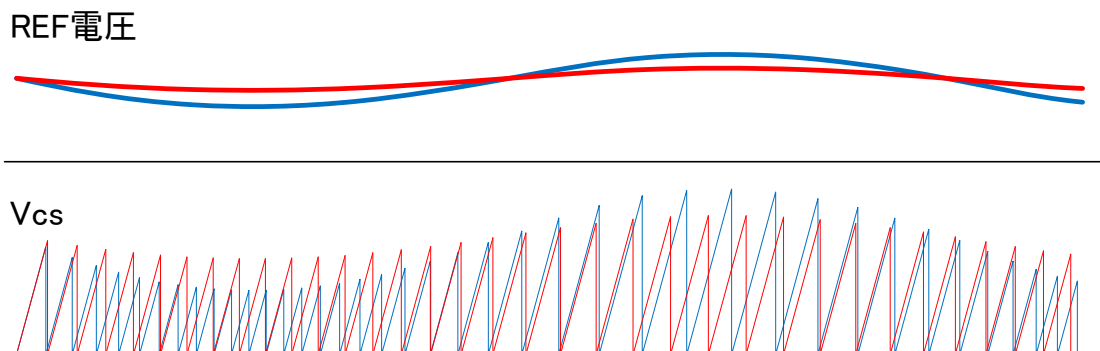


図9 REFリプル電圧に差を付けた時の動作イメージ図

MV2002SG / MV2052SG

3.2.1 MOSFET の選定 (Q11、Q21)

MOSFET には図 6 のような V_{DS} 電圧が印加されます。印加電圧の最大値は、ほぼ入力電圧の最大値と等しくなりますが、実際にはパターンの L 成分などによりスパイク電圧が発生することがあります。実機でご確認のうえ耐圧に余裕のある部品を選定してください。

電力の大きい照明器具ではオン抵抗の低い MOSFET が有効ですが、小電力の照明器具では C_{iss} や C_{oss} などの容量成分の小さい MOSFET を選定した方が高効率で、かつ良好な調光特性を得ることができます。

IC の消費電力は入力電圧と消費電流の積、消費電流はロジック電流とゲート駆動電流の和となりますので、できるだけゲート容量の小さい MOSFET を選定してください。(表 2 MOSFET 推奨部品 参照)

表 2 MOSFET 推奨部品 (2020 年 3 月現在)

製品名	耐圧(V)	ID(A)	Ron(typ)	Ron(max)	Qg(nC)	Ciss(pF)	Coss(pF)	メーカー	パッケージ
P3B28HP2	280	3	1.7	2	3.6	120	25	新電元	FB
P6B28HP2		6	0.66	0.85	5.7	240	43	新電元	FB
P1R5B40HP2	400	1.5	4.2	5	3.9	120	20	新電元	FB
P4B40HP2		4	1.54	1.9	6.5	245	33	新電元	FB
P1B52HP2	525	1	6	7.2	4.3	125	20	新電元	FB
P5B52HP2		5	1.4	1.7	10.5	400	45	新電元	FB
P6B52HP2		6	1.1	1.35	15	520	58	新電元	FB
P0R5B60HP2	600	0.5	8.3	10	4.3	120	18	新電元	FB

3.2.2 回生ダイオードの選定 (D11、D21)

MOSFET 同様に入力電圧以上の耐圧が必要です。また、 $t_{rr}=100\text{nsec}$ 以下を目安に高速スイッチングに適した FRD(ファストリカバリダイオード)を選定してください。(表 3 回生ダイオード推奨部品 参照)

表 3 回生ダイオード推奨部品 (2020 年 3 月現在)

製品名	耐圧(V)	Io(A)	V_F (V)	Cj(pF)	t_{rr} (ns)	メーカー	パッケージ
D1FL20U	200	1.1	0.98	-	35	新電元	1F
D2FL20U		1.5	0.98	-	35	新電元	2F
D1FL40U	400	1.5	1.2	11	25	新電元	1F
D2FL40		1.3	1.3	-	50	新電元	2F
D1FK60	600	0.8	1.3	11	75	新電元	1F
D2FK60		1.5	1.3	16	75	新電元	2F

MV2002SG / MV2052SG

3.2.3 電流検出抵抗の選定 (R111,R112、R211,R212)

VREF が 2.7V のときに定格電流になるように設計した場合、CS 端子の電流検出しきい値 $V_{th_CS_2_7}=0.538V$ 、 $R111//R112$ ($R211//R212$)= R_{cs} とします。図 6 において、 t_{off2} が t_{on} 、 t_{off1} に対して十分に小さい場合、 I_d のピーク電流 I_p は出力電流 I_o の 2 倍となるため、 R_{cs} は 100%調光時出力電流 $I_o(max)$ を用いて次のように計算することができます。

$$R_{cs} = \frac{V_{th_CS_2_7}}{I_p} = \frac{0.538}{2 \times I_o(max)}$$

現実としては、 t_{off2} および検出の遅れにより実際の電流値は計算値と若干異なりますので、適切な抵抗値は実機にて調整してください。

VREF を 3.3V 以上のときに定格電流になるように設計しても動作には問題ありませんが、相対電流精度は悪くなりますので注意してください。

3.2.4 インダクタの選定 (L11、L21)

入力電圧を V_i 、出力電圧(LED 電圧)を V_o 、スイッチング周波数を f 、インダクタンスを L 、回生ダイオードの順方向電圧降下を V_F とした場合、 t_{off2} を無視するとインダクタンスは次のように計算できます。

$$L = \frac{(V_i - V_o) \times (V_o + V_F)}{2 \times f \times I_o \times (V_i + V_F)}$$

スイッチング周波数は、入出力電圧変動および調光によって変動します。

一般にインダクタには図 10(a)のような直流重畳特性があり、電流が増えるとインダクタンスが低下します。これにより、図 10(b)の実線のような MOSFET の電流波形となるため、出力電流 I_o は計算値より若干小さくなります。

また、インダクタには出力電流 I_o の約 2 倍のピーク電流 I_p が流れるため、 I_p におけるインダクタンス低下に注意して部品を選定してください。

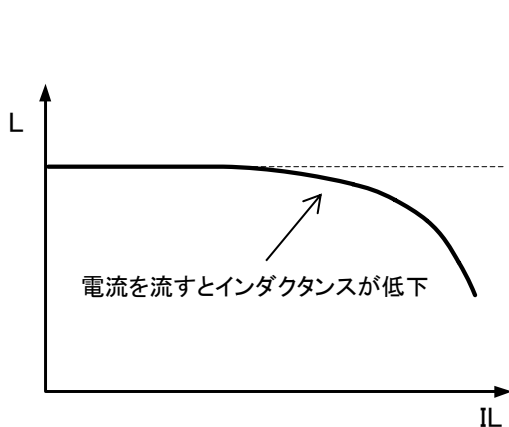


図 10(a) インダクタの直流重畳特性

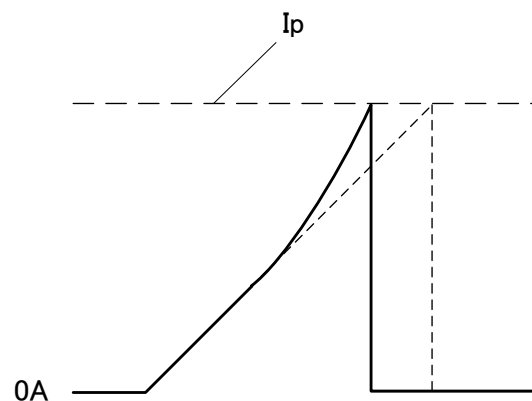


図 10(b) インダクタンス低下時の MOSFET 電流波形

MV2002SG / MV2052SG

3.2.5 ゲート駆動回路の選定 (R13,R14,D12、R23,R24,D22)

IC 内部でゲートの充電電流(I_{G_source})は約 46mA、放電電流(I_{G_sink})は約 475mA に制限されているため、R13(R23)=0Ω すなわち直結でも使用することができます。R13 を挿入することで遅延時間の調整、ノイズの低減、調光特性の改善などを行うことができます。ただし、挿入する R13 の抵抗値を大きくしすぎると、一度リスタート動作に入るとゼロ電流検出ができなくなり、リスタート動作を継続してしまう可能性があります。R13 の抵抗値を決める際には、REF 電圧をスローアップして発振開始させた場合においても、ゼロ電流検出ができることを必ず確認してください。

また、放電電流は制限せず、良好な定電流特性を得るために、放電用のダイオード D12(D22)と抵抗 R14(R24)を用いてください。R14 で放電電流を調整してください。

なお、上記充電電流値および放電電流値については V_{cc}=10V 時の値であり、V_{cc} の値によって電流値は異なります。

3.2.6 Svin,Svout 端子の抵抗の選定 (R151,R152,R161,R162、R251,R252,R261,R262)

Svin,Svout 端子は、インダクタの両端電圧の反転を検出してオンタイミングを決定(ゼロ電流検出)するためのコンパレータ入力です。コンパレータの良好な特性を得るために、端子入力電圧は 3.5V 以下としてください。インダクタの両端は高電圧なので、図 11 の回路図のように分圧抵抗(R151~R162)が必要となります。

なお、基本回路の構成上、分圧抵抗(R151~R162)と IC 内部抵抗を介して LED リーク電流が流れます。IC 停止時および発振停止時の出力電流を小さくしたい場合は、3.3 項記載の補助巻線使用タイプで設計してください。

Svin 端子、Svout 端子の電圧波形と内部回路図を図 11 に示します。

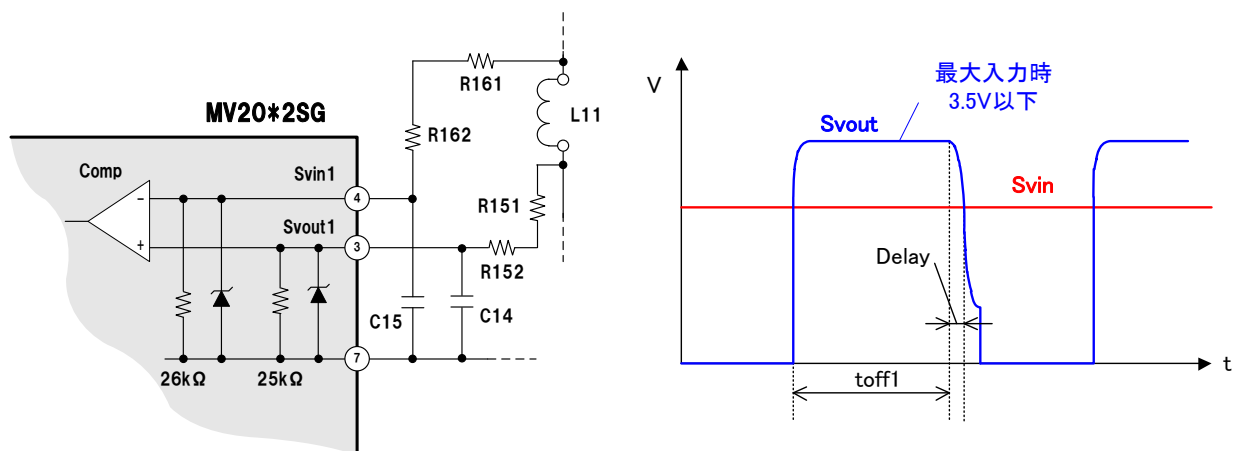


図 11 ゼロ電流検出動作波形と内部回路図

最大入力電圧のとき、Svout 端子の電圧が 3V 程度となるように、下記式にて R151,R152(R251,R252)を選定してください。

$$R151 + R152 = \frac{25k \times (V_{i_max} + V_F)}{3} - 25k$$

$$R161 + R162 = R151 + R152$$

MV2002SG / MV2052SG

Svin 端子および Svout 端子の内部プルダウン抵抗は、それぞれ 26k Ω と 25k Ω になっており、約 4%の抵抗差を設けております。R161+R162 を R151+R152 と等しくすることで、LED ショート時に常に Svin 電圧が Svout 電圧を超え、ノイズによる誤オンを防ぎます。

Svin 端子および Svout 端子の外部抵抗を選定する際は、 $\pm 1\%$ 以下の高精度品をご使用ください。

なお、出力電圧 V_o が最大入力電圧 V_i に対して 10%以下となる仕様の場合は、ゼロ電流検出ができなくなる可能性があります。その場合は、3.3 項記載の補助巻線使用タイプで設計してください。

3.2.7 CS 端子フィルタの選定 (R12+C12、R22+C22)

R12(R22)および C12(C22)は、CS 端子へのノイズの侵入を防止するためのフィルタです。R12 を 0 Ω ～数 k Ω 程度、C12 を 10pF～100pF で調整することで、オフ時間変調領域でのターンオンノイズによるオフタイミングの誤検出を改善することができます。なお、フィルタ定数を調整する際には、REF 電圧仕様範囲で REF 端子電圧 V_{REF} を細かく刻み、実機にて誤検出の有無を確認してください。(詳細については、P.24-25 5.1.2 項【B】オフ時間変調領域】を参照してください)

一方でフィルタ定数を大きくしすぎると検出遅れが大きくなり、設定出力電流値および入力電圧による出力電流変動が大きくなります。必要に応じて電流検出抵抗やインダクタを再選定してください。

3.2.8 Vcc 端子平滑用コンデンサの選定 (C2)

C2 は、Vcc 端子の電源電圧を安定させるためのコンデンサです。Vcc 端子電圧波形をご確認の上 0.1 μ F 以上のコンデンサを選定してください。極端に大きい容量を選定すると起動時間が長くなりますので、実機にて確認してください。

3.2.9 REF 端子のコンデンサの選定 (C13,C23)

C13(C23)は、ノイズによる誤動作を防止するためのコンデンサです。コンデンサ容量は、1000pF 程度としてください。調光方法については、P.22 5 項【調光特性について】を参照してください。

3.2.10 Svin 端子のコンデンサ(C15,C25)の選定

C15(C25)は、ノイズによる誤動作を防止するためのコンデンサです。コンデンサ容量は、1000pF 程度としてください。

3.2.11 共振コンデンサ(Cr1,Cr2)の選定

Cr1(Cr2) を追加することにより、共振期間の調整だけでなくターンオフノイズを低減する効果があります。ただし、ターンオンノイズが増える場合があるため、注意が必要です。また、Cr が大きいと調光特性および効率が悪化するため、通常は未実装を推奨しております。追加する場合は必要最小限となるよう実機にて調整してください。

MV2002SG / MV2052SG

3.2.12 入力コンデンサ(C101)、出力コンデンサ(C111,C211)の選定

入出力コンデンサは、リップル電流許容値、寿命、出力保持時間等を考慮して選定してください。コンデンサのリップル電流については、以下の計算式で算出することができます。

入力コンデンサのリップル電流

$$I_{ripin} = I_{p1} \times \sqrt{D1 \times \left(\frac{1}{3} - \frac{D1}{4} \right)} + I_{p2} \times \sqrt{D2 \times \left(\frac{1}{3} - \frac{D2}{4} \right)}$$

出力コンデンサのリップル電流

$$I_{ripout} = \frac{I_o}{\sqrt{3}}$$

ここで、 I_{p1} 、 I_{p2} は L11 および L21 のピーク電流を、 $D1$ 、 $D2$ は CH1 および CH2 のスイッチングデューティを表します。

D は入出力電圧の関係から次の式で求めることができます。

$$D1 = \frac{V_{o1}}{V_i}$$

$$D2 = \frac{V_{o2}}{V_i}$$

入力コンデンサには全波整流や PFC など入力回路側のリップルが重畳されますので考慮して選定してください。

3.2.13 Svout 端子のコンデンサ(C14,C24)の選定

C14(C24)は、図 11 における Delay を調整し、オンタイミングを調整するためのコンデンサです。共振周期はインダクタや MOSFET などの部品によって変わります。図 12 の $toff2$ が共振周期の半分になるように Delay を調整すると、MOSFET は共振電圧の谷点でオンとなるのでスイッチング損失、ノイズが最も小さくなります。C14 が大きいほど Delay は大きくなり、通常は 10pF～数十 pF 程度の間で最適となります。なお、ノイズによる誤動作防止用として、C14 は 10pF 以上の容量を推奨いたします。

MV2002SG / MV2052SG

擬似共振動作における共振期間についての補足説明

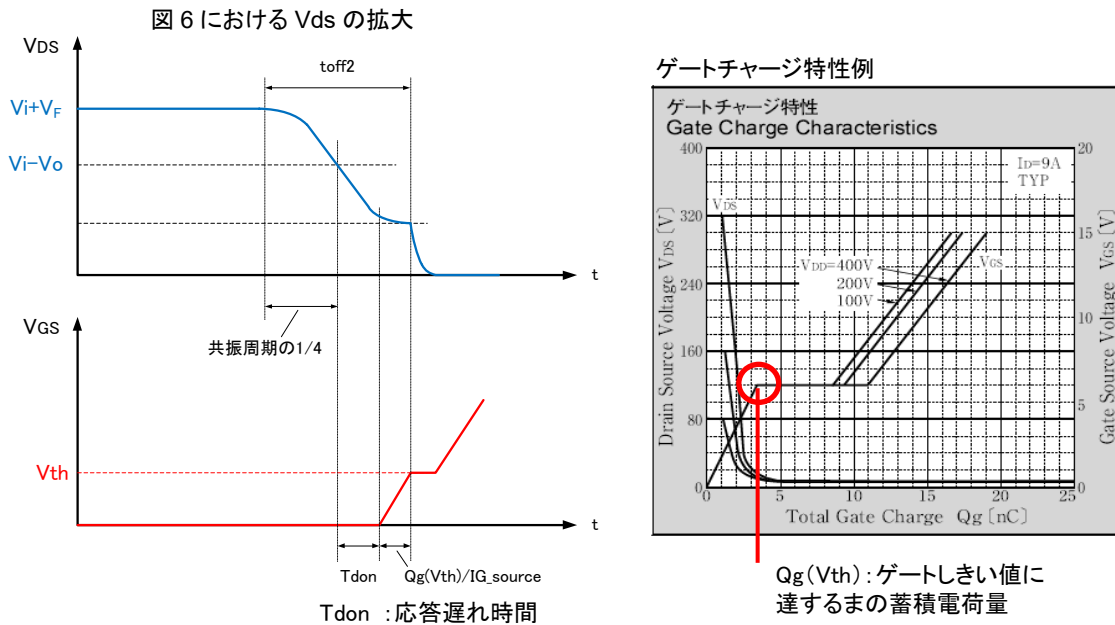


図 12 Delay 時間の調整

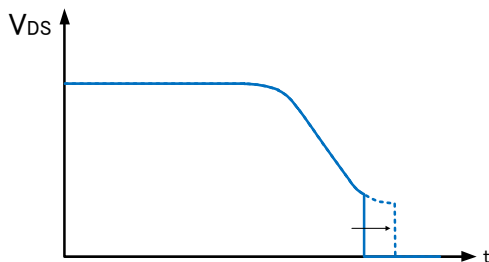
理想的には図 12 のように共振の谷で MOSFET がオンすることが望ましく、そのときの条件は以下の式で表すことができます。

$$\frac{1}{4} \times 2\pi \sqrt{L \times (Cr + Coss + Cj)} = Td_{on} + \frac{Qg(Vth)}{Ig}$$

Coss: MOSFET の出力容量 Cr: D-S 間コンデンサ容量 Cj: 回生ダイオードの接合容量

このとき、Vb=Vi-2Vo-VF となるため、スイッチングロスが最も少なくなります。実際には必ずしも上記の条件とはなりません、厳密に谷点でオンする必要はありません。極端にずれている場合は下記の方法で調整することができます。

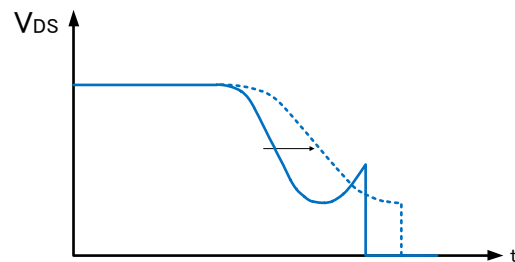
(1) 左辺が大きい場合



⇒オンタイミングを遅らせる

・(C14,C24)または R13(R23)を大きくする

(2) 右辺が大きい場合



⇒共振周期を長くする

・Cr1(Cr2)を大きくする

MV2002SG / MV2052SG

3.3 補助巻線使用タイプについて

3.3.1 補助巻線使用タイプ回路構成

MV2002SG/MV2052SG は図 13 のように補助巻線を使用する事で、LED オープン時などの出力過電圧保護が可能となります。また、出力電圧 V_o が最大入力電圧 V_i に対して 10%以下となる仕様の場合にも確実に動作させることができます。(P.15 3.2.6 項【Svin,Svout 端子の抵抗の選定】参照)
部品選定については、補助巻線および補助巻線整流用ダイオードの選定が必要となります。

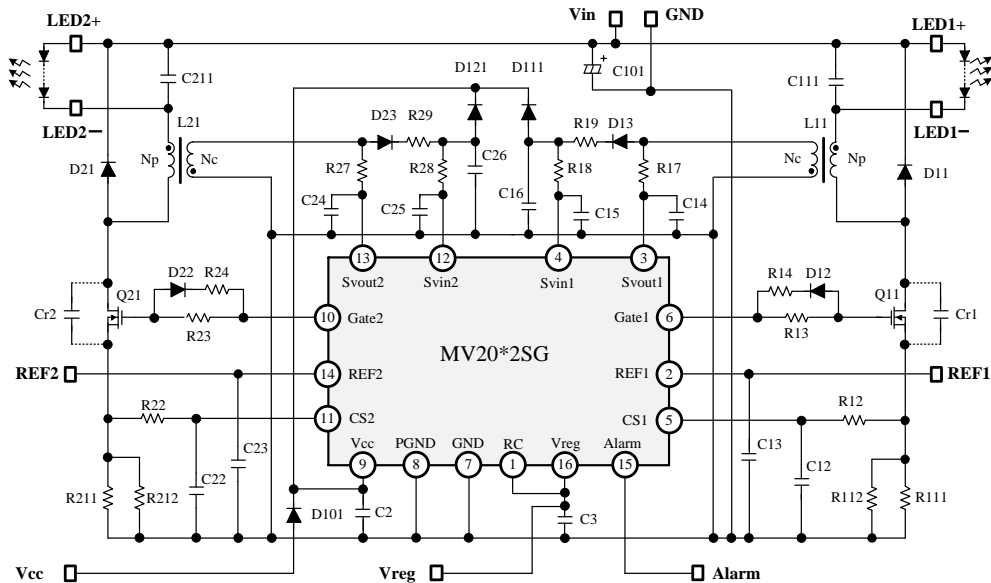


図 13 補助巻線使用タイプ回路構成

3.3.2 補助巻線(Nc)の選定

補助巻線電圧を整流し V_{cc} 端子に印加される電圧を V_c とすると、以下の式より V_c を求めることができます。調光や LED の VF バラツキによる V_o 変動を考慮して、 V_c 電圧が 10V~16V の範囲となるように巻数比を選定してください。

$$\frac{N_c}{N_p} \cong \frac{V_c}{V_o}$$

Np: インダクタンスの巻数[T]
Nc: 補助巻線の巻数[T]

巻線の巻数比や結合状況によっては補助巻線にサージ電圧が発生し、設定した V_c 電圧よりも高くなる可能性があります。実機にて、 V_c 電圧が 10V~16V の範囲に収まっていることを確認してください。

3.3.3 補助巻線整流用ダイオード(D13,D23)の選定

D13(D23)には次の式で表される逆電圧 V_r が印加されます。耐圧に注意して選定してください。

$$V_r = V_i \times \frac{N_c}{N_p}$$

入力電圧が最大のときに D13 の逆電圧も最大となります。なお、D13 には FRD(ファストリカバリダイオード)をご使用ください。(表 4 整流用ダイオード推奨部品 参照)

MV2002SG / MV2052SG

表 4 整流用ダイオード推奨部品 (2016年1月現在)

製品名	耐圧(V)	Io(A)	V _F (V)	C _j (pF)	trr(ns)	メーカー	パッケージ
M1FL20U	200	1.1	0.98	-	35	新電元	M1F
M1FL40U	400	1.5	1.2	11	25	新電元	M1F
D1FK60	600	0.8	1.3	11	75	新電元	1F

また、D13 と直列に抵抗 R19(R29)を挿入することで、補助巻線のサージ電圧による V_c 電圧の上昇を低減することができます。

R17(R27),R18(R28)については、R17(R27)=1MΩ、R18(R28)=220kΩを使用してください。

なお、補助巻線使用タイプでの Svin 端子,Svout 端子の波形は図 14 のようになります。

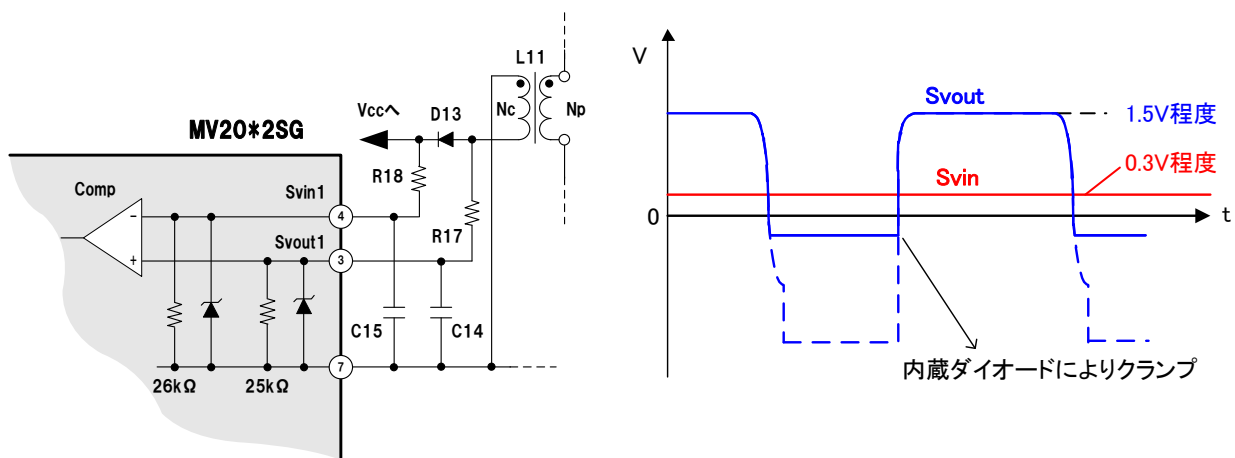


図 14 補助巻線使用タイプでの Svin 端子,Svout 端子波形

3.3.4 補助巻線を利用した LED オープン保護

図 13 の構成でインダクタの補助巻線を利用することにより、LED オープン時などの出力過電圧を保護することができます。V_{cc} 端子には過電圧を検出してラッチ停止する機能があり、V_{cc} 端子電圧が 20.7V(typ.)で動作を停止します。図 13 の極性に補助巻線を巻いた場合、補助巻線電圧は出力電圧に比例するため、LED オープンにより発生する過電圧を間接的に検出し V_{cc} 過電圧保護によりラッチ停止させることができます。

ラッチ停止するときの出力電圧 V_{ovp} は、次の式より求めることができます。

$$V_{ovp} = \frac{20.7}{V_c} \times V_o$$

なお、入力電圧 V_i と出力電圧 V_o の差が小さい仕様では、V_{cc} 電圧が 20.7V に達しない場合があり、補助巻線による LED オープン保護が働かない可能性があります。

MV2002SG / MV2052SG

4.パターン設計上の注意

4.1 注意事項

図 15 は図 5 と同じ回路で、パターン設計を考慮して書き換えた配線図になります。パターン設計する際には、下記 4 点について十分考慮してください。特に、項目 1 で記載しているとおり、ターンオフノイズが別 CH 側に影響しないように、片方の信号ラインと別 CH の主経路や Gate ラインをできるだけ近づけないように配線してください。

1. 点線で囲んだ部分は制御回路です。制御回路は主回路のノイズや磁束の影響をできるだけ受けないように配慮してください。制御回路の GND はできるだけ一点で、入力コンデンサの一端子など主回路の安定した部分と接続してください。REF, Svin, Svout, CS 端子などに信号を入力する配線は特に注意し、できるだけ高圧回路に近づけないとともに別 CH の主経路や Gate ラインの近くに配線しないように配慮してください。
2. 網かけで示す部分はスイッチング電流が流れる主回路です。この部分の面積ができるだけ小さくなるように最優先で短く配線してください。また、図 15 のように、CH1 と CH2 の電流経路を分けて配線してください。
3. インダクタ周辺には磁束が発生します。磁束の漏れ出しが小さい閉磁路型のインダクタを用い、インダクタの直下に信号線を近づけないようにしてください。
4. 同一 CH の Svin, Svout 端子の配線はできるだけ並行して配線してください。

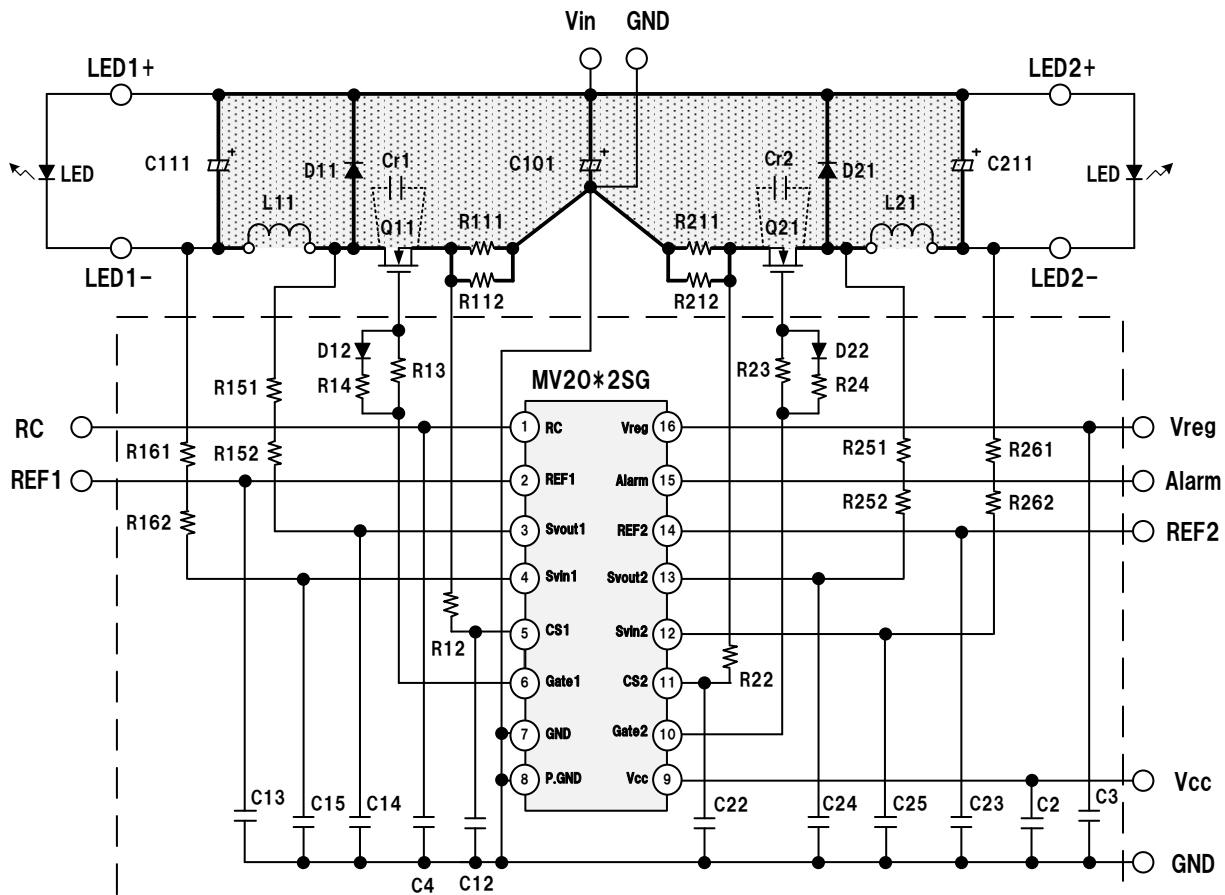


図 15 パターン設計を考慮した回路配線図

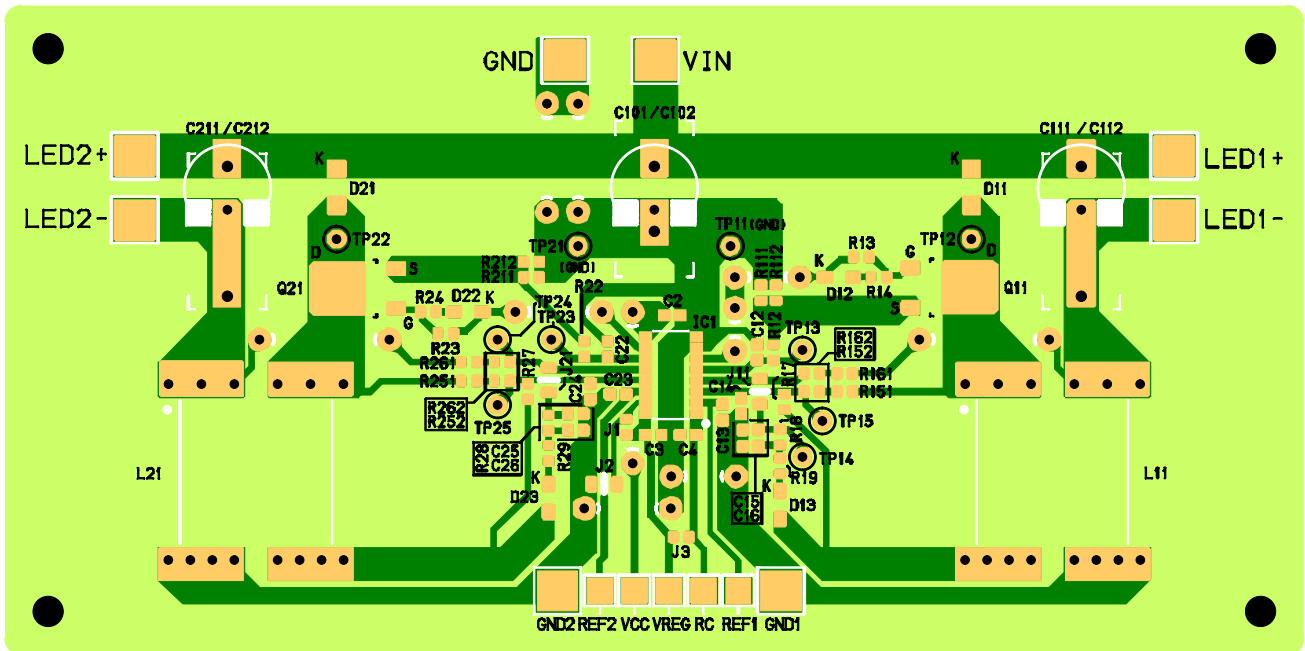
MV2002SG / MV2052SG

4.2 基板パターン例

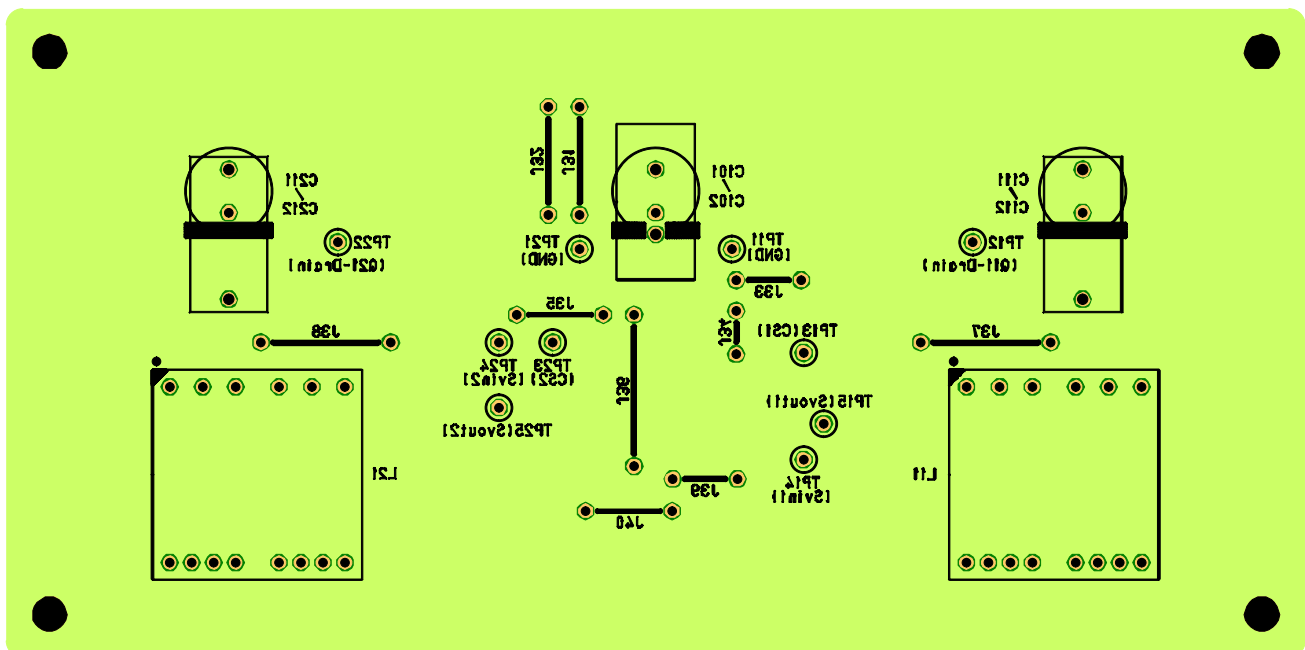
弊社サンプルボードによる参考パターンを下記に示します。サンプルボードは入力ヒューズおよび入力ラインフィルタが付加されたパターンにはなっておりませんので、実使用時には別途付加してください。

下のパターンは例であり、実動作を保証するものではありません。必ず実機にて動作確認を行ってください。

<表面>



<裏面>



【基板サイズ 縦 75mm × 横 150mm】

MV2002SG / MV2052SG

5.調光特性について

MV2002SG / MV2052SG の代表的な調光特性は、図 16 に示すような特性になります。

IC 内部において、REF 端子電圧 V_{REF} に応じて CS 端子の基準電圧を変化させます。そのため、 V_{REF} を調整することでピーク電流を調整することができ、リニア調光が可能になります。オフ時間が短くなると、自動的に電流臨界動作から電流不連続動作に切り替えるため、非常に小さい出力電流までリニア調光で調光することが可能になります。また、REF 端子に 1kHz 以下の PWM 信号を印加し PWM 信号の Duty を制御することで、PWM 調光が可能です。

図 16 の[A]周波数変調領域と[B]オフ時間変調領域のモード切り替わりは、 $T_{off}(CRM)$ と $T_{off}(DCM)$ を IC 内部で比較し、自動的に切り替わります。 $T_{off}(CRM)$ は電流臨界動作におけるオフ時間 (p.11 図 6 内の式で算出される t_{off1} と共振期間 t_{off2} の和) であり、 $T_{off}(DCM)$ は V_{REF} に応じて IC 内部で決定される強制オフ時間になります。動作モードは、 $T_{off}(CRM) > T_{off}(DCM)$ の場合は[A]周波数変調領域になり、 $T_{off}(CRM) < T_{off}(DCM)$ の場合は[B]オフ時間変調領域となります。モード切り替わり REF 端子電圧については、入出力条件やチョークコイルのインダクタンス値等によって変わります。強制オフ時間 $T_{off}(DCM)$ は、下式の近似式を参考に算出してください。

$$T_{off}(DCM) \cong \frac{195.5}{206 \times V_{REF}^2 + 62 \times V_{REF} - 45} + 0.3 \quad [\mu s] \quad (0.4V < V_{REF} < 0.75V)$$

図 16 の下図に REF 端子電圧 vs オフ時間の例をグラフに示します。図内の赤線は $T_{off}(CRM)$ を、緑線は $T_{off}(DCM)$ を示しています。なお、 V_{REF} が $(V_{th_REF_st} - V_{th_REF_hys})$ 以下の場合は、[C]発振停止領域になります。

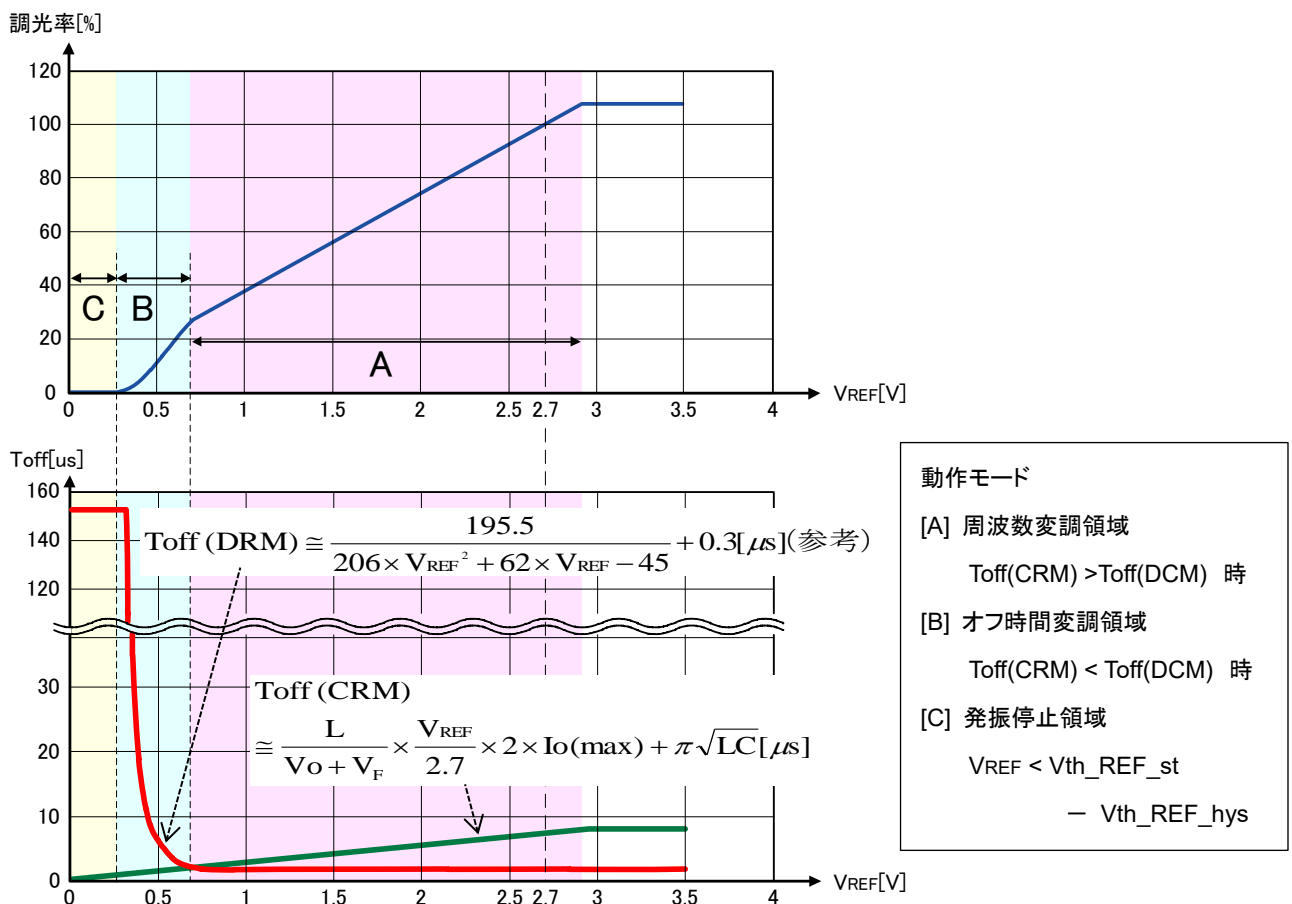


図 16 REF 端子電圧 V_{REF} と調光率およびオフ時間 T_{off} の関係

MV2002SG / MV2052SG

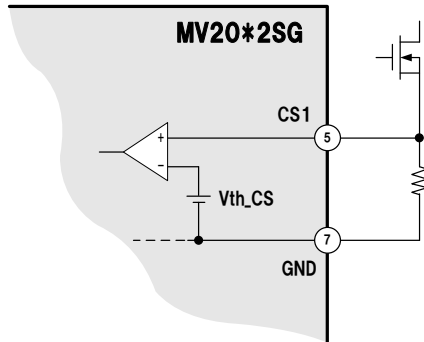
5.1 各モードの動作

5.1.1 [A]周波数変調領域

周波数変調領域では、図 18 に示すような電流臨界動作波形になります。CS 端子の内部回路は図 17 のようになっており、 $V_{REF} \times 1/5$ の電圧と電流検出しきい値電圧 V_{th_CS} (0.585V) を比較して、低い方の電圧を CS 端子の基準電圧とします。 V_{th_CS} と V_{REF} を 1/5 にする回路では、後者の方がバラツキは小さくなります。CH1 と CH2 の相対電流精度を良くしたい場合は、 V_{th_CS} 以下の V_{REF} において定格電流になるように設計してください(推奨は、 $V_{REF} = 2.7V$ で定格電流に設定)。なお、確実に V_{th_CS} を基準電圧にしたい場合は、 V_{th_CS} と $V_{REF} \times 1/5$ の電圧のバラツキを考慮して、 V_{REF} を 3.3V 以上にしてください。

t_{on} や t_{off1} に対して共振期間 t_{off2} が十分に小さい場合は、IL は三角波と見なせるため $I_o = 1/2 \times I_p$ となり、出力電流 I_o は V_{REF} と比例関係になります。ただし、 V_{REF} が低くなるにつれ発振周波数が高くなるため、1 周期における t_{off2} や検出遅れ時間の割合が大きくなり、 I_o と V_{REF} の比例関係に多少のズレが生じる可能性があります。

REF 端子電圧 $V_{REF} \geq V_{th_CS} \times 5$



REF 端子電圧 $V_{REF} < V_{th_CS} \times 5$

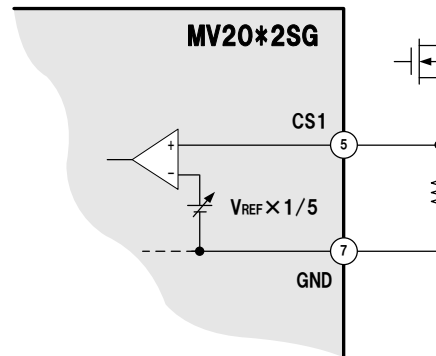


図 17 CS 端子の内部回路図

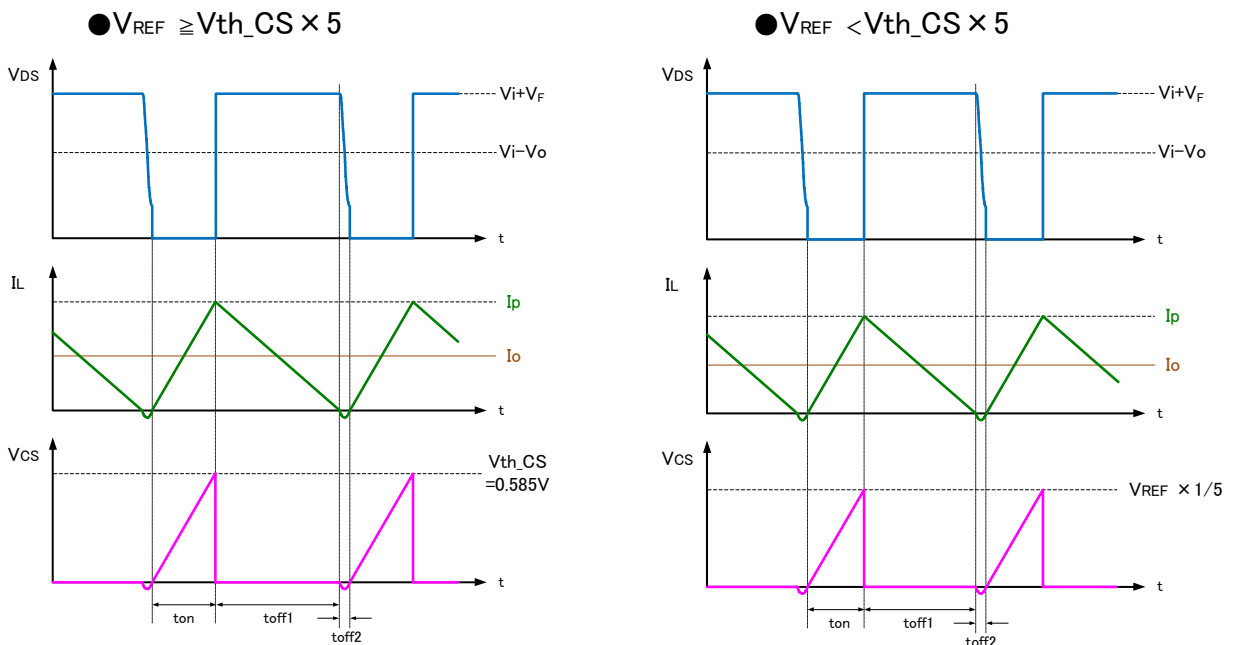


図 18 [A]周波数変調領域の動作波形

MV2002SG / MV2052SG

5.1.2 [B]オフ時間変調領域

オフ時間変調領域では、図 19 に示すような電流不連続動作波形になります。VREF の低下に応じて強制オフ時間 toff(DCM)を延ばすことで、非常に小さい出力電流まで制御できます。なお、強制オフ時には、D11(D21)に電流が流れる期間 toff1 も含まれます。図 6 内の計算式より、toff1 は Vo に依存するため、Vo が変動すると[B]領域における Io も変動します。

[B]領域においても、CS 端子の基準電圧は VREF × 1/5 の電圧となり、[A]領域よりも VREF は低いため基準電圧も[A]領域より低くなります。そのため、[B]領域では CS 端子へのノイズの影響を受けやすく、本来のピーク電流検出と異なるタイミングで MOSFET をオフする可能性が高くなります。また、ターンオンタイミングは共振電圧の谷点からズレるため、ターンオン時の VDS 電圧が Vb より高くなり、ターンオンノイズが大きくなります。ノイズで MOSFET がオフしないように、ターンオン後にノイズを受け付けないリーディングエッジブランキング (LEB) 期間を設けています。(図 20(b)) しかし、LEB 期間後においても、ターンオンノイズや外部回路から侵入してきたノイズが CS 端子の基準電圧を上回る場合は、それらのノイズを誤検出することにより MOSFET がオフしてしまいます。(図 21(b)) その結果、本来の Io よりも小さくなり、ノイズのタイミングによっては LED 光のチラツキの原因になります。

MOSFET の Coss、共振コンデンサ Cr、回生ダイオードの Cj の容量が大きいと、ターンオンノイズは大きくなります。ターンオンノイズにより誤検出が発生している場合には、CS フィルタの調整 (P.15) やゲート抵抗の調整 (P.14) を行うか上記部品の再選定を行ってください。

なお、簡易的な誤検出の確認方法としては、VREF を細かく刻み、ピーク電流検出ではない明らかに狭小な ton が存在することを Gate 波形より確認してください。その際、Vcs や VDS 電圧を測定すると動作が変わってしまう可能性があります。確認の際は、Gate 端子波形のみで測定することを推奨いたします。

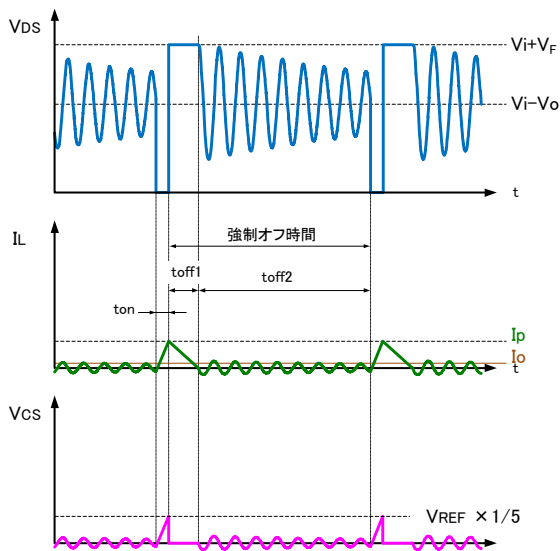


図 19 [B]オフ時間変調領域の動作波形

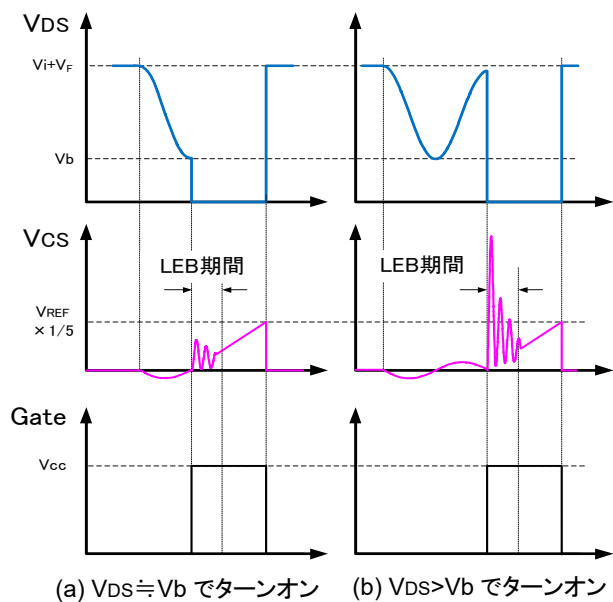


図 20 VDS によるターンオンノイズの例

MV2002SG / MV2052SG

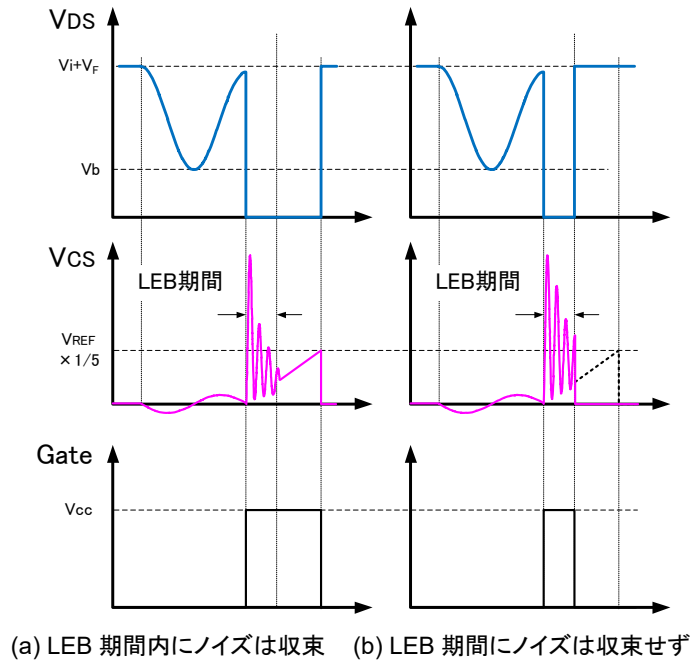


図 21 ターンオンノイズによる誤検出の例

一方で、toff2 期間に流れる共振電流は電流検出抵抗 R_{cs} にも流れるため、toff2 期間における V_{cs} は 0V 前後で振動します。図 22 のように同じ V_{REF} においても、ターンオン時の V_{cs} が 0V よりも高いか低いかによりオン時間が大きく変動する場合は、 I_o の精度や調光特性の滑らかさを低下させる(図 23 の「 V_{REF} のリプル小」参照) 要因となります。

toff2 期間中の V_{cs} の振幅は、MOSFET の C_{oss} と共振コンデンサ C_r の容量を小さくすることで低減できます。また、 V_{REF} のリプル電圧を大きくすることで、オン時間の変動を平均化することができ、ターンオン時の V_{cs} に依存した I_o 変動を低減することができます。(図 23 の「 V_{REF} のリプル大」参照)

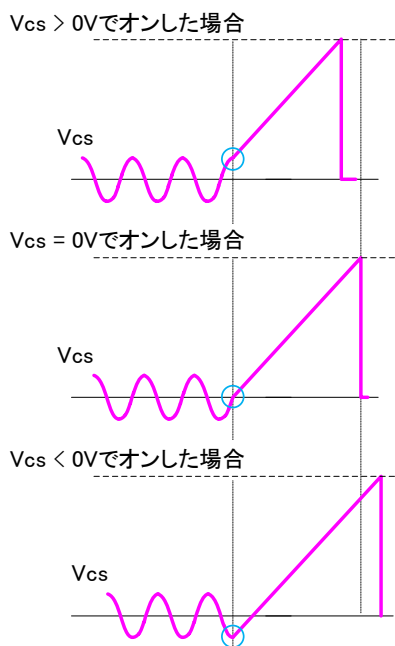


図 22 [B]領域におけるオンタイミングによるオン時間の変動

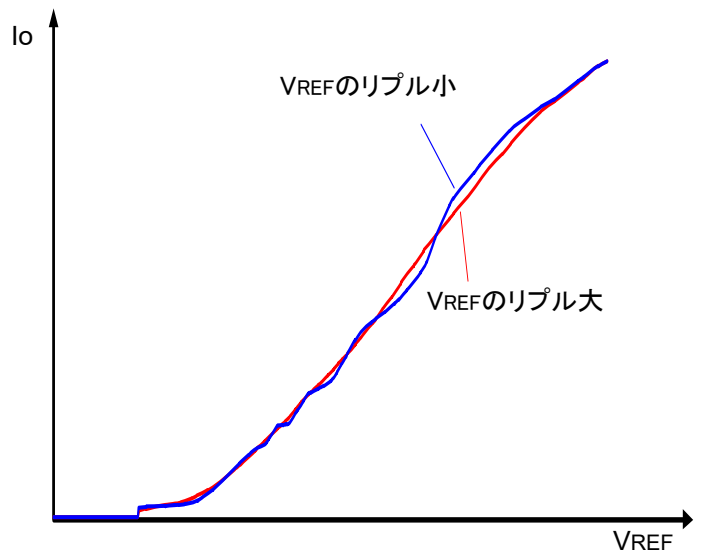


図 23 調光特性の“滑らかさ低下”のイメージ

MV2002SG / MV2052SG

5.1.3 [C]発振停止領域

MV2002SG/MV2052SG では、 V_{REF} を $(V_{th_REF_sp} - V_{th_REF_hys})$ 以下にすることで Gate 発振を停止させることができます。MOSFET を完全にオフさせるため、[B]領域に比べて I_o をゼロに近づけることができます。

図 5 の基本回路構成では、 S_{vin} 端子と S_{vout} 端子の内部抵抗を介して、常にリーク電流が流れます。リーク電流は[A]領域と[B]領域でも存在しますが、MOSFET を完全にオフさせている[C]領域では I_o はリーク電流のみとなります。このリーク電流の値は、入出力電圧差や $R_{151}, R_{152}, R_{161}, R_{162}$ ($R_{251}, R_{252}, R_{261}, R_{262}$) の抵抗値によって決まります。リーク電流を無くしたい場合は、補助巻線使用タイプで回路構成してください。

なお、 $V_{th_REF_st}$ と $V_{th_REF_hys}$ の規格値はバラツキが存在します。確実に[C]領域を使用するためには、 V_{REF} は 0.12V 以下に設定してください。

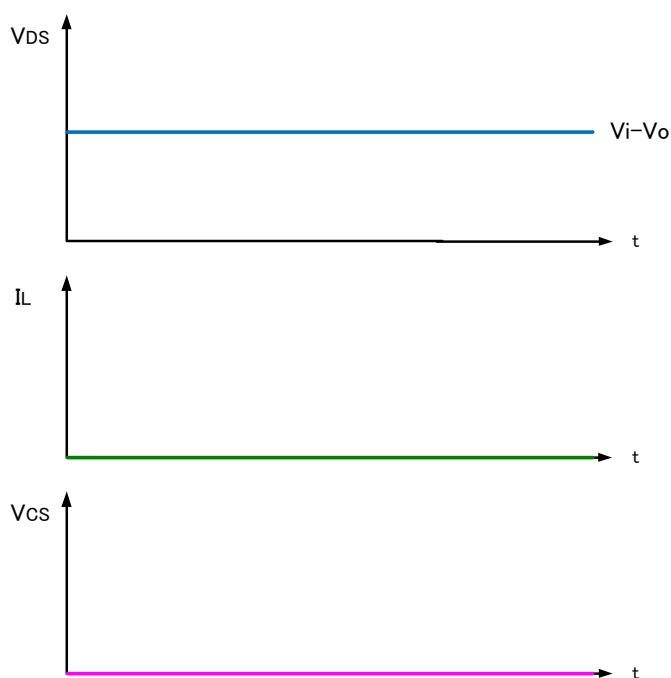


図 24 [C]発振停止領域の動作波形

5.2 PWM 調光について

5.2.1 100%調光と発振停止領域での PWM 調光

ハイを 100%調光の V_{REF} (ここでは 2.7V とする)、ローを発振停止領域の V_{REF} とした PWM 信号を REF 端子に印加することで、PWM 調光を行うことができます。なお、PWM 信号の周波数 f およびオンデューティ Don については、 $f=1\text{kHz}$ 以下、 $Don=1\%$ 以上で使用してください。

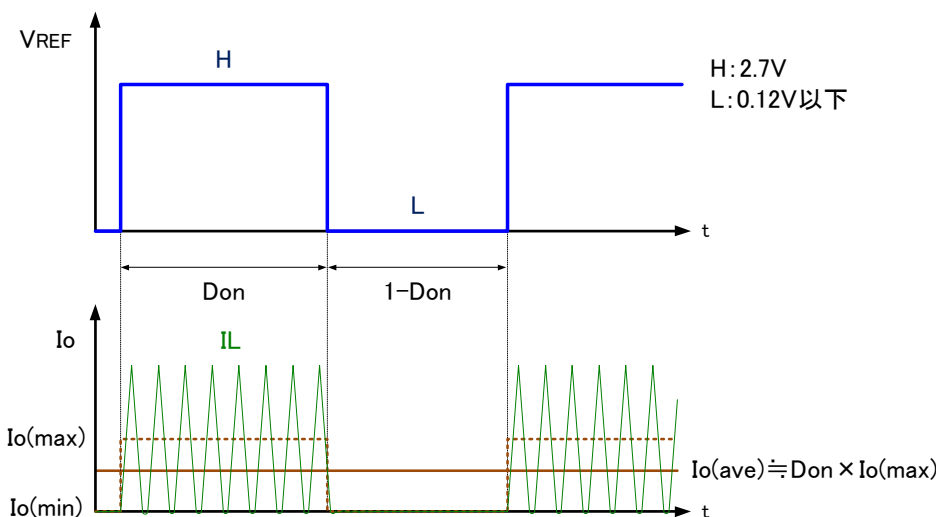


図 25 PWM 調光動作の例

図 25 のように、REF 端子にオンデューティ= Don の PWM 信号を印加したとき、 I_o は平均電流 $I_o(ave)=Don \times I_o(max)+(1-Don) \times I_o(min)$ となります。実際には、 $I_o(min)$ がほぼゼロになるため $I_o(ave) \doteq Don \times I_o(max)$ と表すことができます。

PWM 調光においては、仮に H 信号期間における最初のターンオンタイミングが不規則になってしまうと、実質的な Don も不規則になり I_o が不安定になります。特に Don が小さい場合では、その影響が大きくなります。そのため、 V_{REF} が L 信号から H 信号に切り替わったことを検出し、強制的にオントリガを出力することで H 信号期間の最初のターンオンタイミングを毎サイクル揃えます。この機能により、 Don が小さい時でも $I_o(ave)$ を安定させることができます。

MV2002SG / MV2052SG

5.2.2 リニア調光とPWM調光の組み合わせ

100%定格電流から微小電流まで良好な出力電流精度を得る手段として、図 26 に示すリニア調光と PWM 調光を組み合わせる方法があります。

[A]領域内の任意の REF 電圧を V_{REF_any} として、その時の I_o を I_o' とします。 I_o' 以上の調光についてはリニア調光で制御し、 I_o' 以下の調光については PWM 調光で制御します。PWM 調光の信号は、ハイを V_{REF_any} 、ローを発振停止領域の V_{REF} とします。このように調光方式を組み合わせることで、PWM 調光方式よりも微小な電流まで調光することができ、かつリニア調光方式よりも良好な出力電流精度で制御することが可能になります。

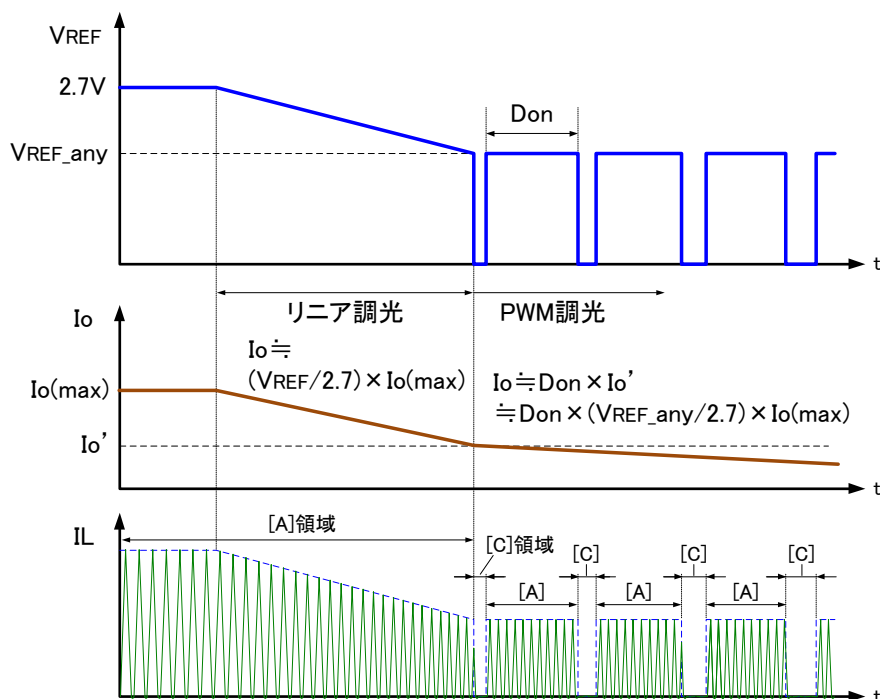


図 26 リニア調光とPWM調光を組み合わせた調光方法

MV2002SG / MV2052SG

5.3 調光回路

MV2002SG/MV2052SG の REF 端子は IC 内部でプルダウンしているため、発振開始させるには外部から電圧を印加する必要があります。外部調光回路の参考として、PWM 信号を平滑する回路例を以下に示します。

5.3.1 PWM 信号を平滑する調光回路例

PWM 調光信号を平滑して REF 端子に印加する調光回路の一例を図 27 に示します。図 27 において、トランジスタ Q101 がオンした時の V_{REF} を V_{REF_H} とし、オフした場合の V_{REF} を V_{REF_L} とすると、各電圧のおおよその値は以下の式で求められます。

$$V_{REF_H} = V_{DD} \times \frac{R102}{(R101 + R102)}$$

$$V_{REF_L} = I_{ref} \times (R103 + R104)$$

V_{REF_H} を 3.3V 以上にすると調光範囲が狭くなるため、上記計算式より 2.7V を目安に $R101+R102$ の抵抗値を設定してください。なお、 V_{DD} は電圧変動が大きいと調光精度に影響するため、安定した電圧を印加してください。

$R103, R104, C101, C102$ の部品により V_{REF_H} と V_{REF_L} が DC 平滑され、以下の式で求まる V_{REF} が REF 端子に印加されます。 $C101, C102$ は、1 μ F 程度を目安に、調光特性を確認しながら容量を調整してください。

$$V_{REF} = (1 - Don) \times V_{REF_H} + Don \times V_{REF_L}$$

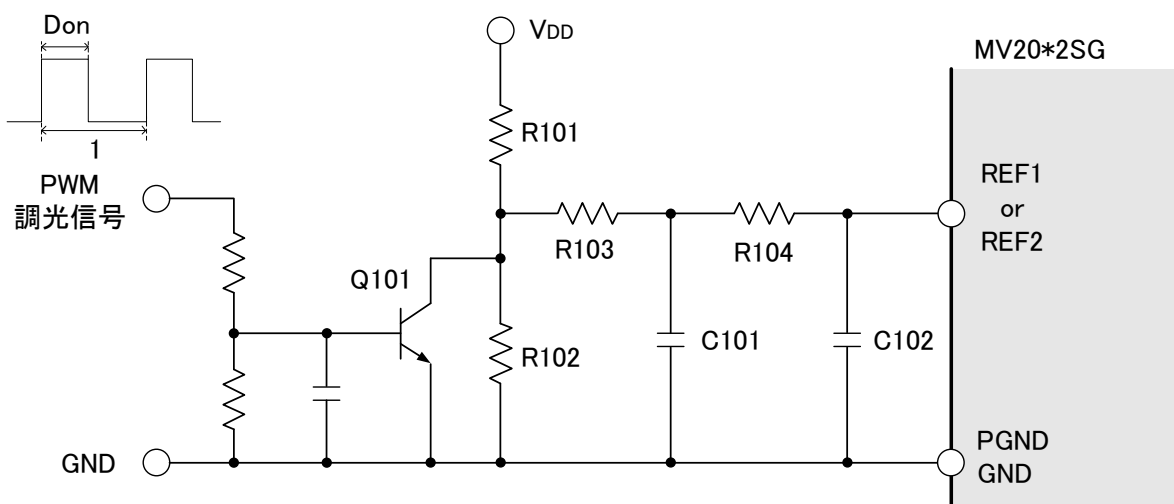


図 27 PWM 調光信号の平滑回路例

MV2002SG / MV2052SG

6. アブノーマル時の動作について

MV2002SG/MV2052SG は各種保護機能を内蔵しておりますが、IC 機能のみでは保護できない異常モードも存在します。参考として、アブノーマル時における主な動作について以下に説明いたします。また、異常時の Alarm 信号出力については、P.10 の「2.4 Alarm 信号出力機能」を参照してください。なお、最終的には実機にてオープン・ショートなどの試験を行い、異常時の動作を確認してください。

6.1 LED オープン

補助巻線電圧と Vcc_OVP 機能を利用することで、LED オープン時にラッチ停止させることができます。詳細については、P.19 の【 3.3.4 補助巻線を利用した LED オープン保護 】を参照してください。

- ① 補助巻線を使う場合
⇒ 補助巻線電圧により間接的に出力電圧を検出し、Vcc_OVP 機能によりラッチ停止
- ② 補助巻線を使わない場合
⇒ 最大オン時間 Ton_max で動作し、Vo≒Vi となります。Ton_max が 128 回続いた後で Alarm 信号が出力されます。
出力コンデンサの耐圧は、入力コンデンサと同等のものを使用してください

6.2 LED ショート

Vo が 0V になるとゼロ電流検出からリスタート動作に自動的に切り替わるため、LED ショート時は強制的に電流を制限することができます。また、ショート解除し出力電圧が上昇すると自動復帰し、ゼロ電流検出で動作します。なお、下記式の条件を満たす場合は電流連続動作になり、MOSFET や再生ダイオードに流れる短絡電流は大きくなる可能性があります。その場合においても問題ないことを、実機にて確認してください。

$$V_i > \frac{T_{\text{restart}}}{T_{\text{on_min}}} \times V_F$$

ここで、VF は再生ダイオード D1 の順方向電圧になります。

図 28 は、LED ショート時の理想的な Svout 端子および Svin 端子の波形です。LED ショート時には、常に Svin 電圧が Svout 電圧を超えるようにしてください。ノイズによる誤オンを防ぐために、Svin 端子および Svout 端子の内部プルダウン抵抗は、26kΩ、25kΩ と約 4% 程度の差を設けております。また、ノイズ印加対策として、Svin 端子および Svout 端子直近にコンデンサを挿入してください。(3.2.10 項、3.2.13 項参照)

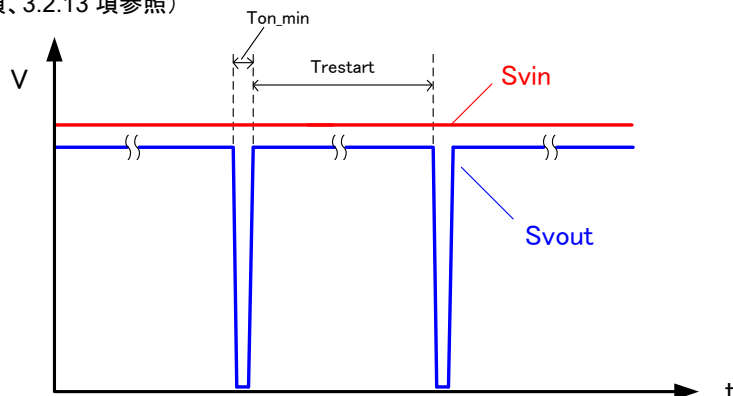


図 28 LED ショート時の Svin 端子、Svout 端子波形

MV2002SG / MV2052SG

6.3 異常発熱

MV2002SG/MV2052SG には、過熱保護機能が内蔵されております。IC のジャンクション温度 (T_j) が過熱保護停止温度 (約 150°C) に達すると過熱保護が働き、2ch とも発振を停止します。また、 T_j が停止温度から約 50°C 下がると、自動復帰します。IC 以外の部品が異常発熱した場合には保護は働きません。必要に応じて別途保護回路を設けてください。

6.4 CS 端子オープン

CS 端子がオープンになると、内部プルアップ電流により V_{cs} が上昇し、CS 端子基準電圧よりも常に高くなります。CS オープンになり V_{cs} が上昇した CH のみラッチ停止します。停止する際、Alarm 信号が出力されます。動作を復帰させるには、CS オープンを解除し、 V_{cc} もしくは RC でリセットしてください。

6.5 CS-GND 端子ショート

CS 端子でピーク電流検出ができなくなり、最大オン時間 T_{on_max} で動作します。 T_{on_max} 動作が連続で 128 回サイクルに達すると、CS-GND ショートになった CH のみ、 T_{on_max} と T_{off_max} で動作するように保護が働きます。ショートが解除されゼロ電流検出ができると、自動復帰します。

6.6 電流検出抵抗オープン

MOSFET のソースがフローティングになり、検出抵抗がオープンになった CH の MOSFET の動作は不安定になります。MOSFET がオフする場合は、 I_o はほぼゼロになりますが、MOSFET がオンした場合については、CS 端子過電圧になり IC が破壊する可能性があります。必要に応じて別途保護回路を設けてください。

6.7 電流検出抵抗ショート

V_{cs} がほぼ GND レベルになるため、最大オン時間 T_{on_max} で動作します。 T_{on_max} 動作が連続で 128 回サイクルに達すると、電流検出抵抗ショートになった CH のみ、 T_{on_max} と T_{off_max} で動作するように保護が働きます。ショートが解除されゼロ電流検出ができると、自動復帰します。

MV2002SG / MV2052SG

7.標準回路例

7.1 電源仕様および回路図

◆ 電源仕様

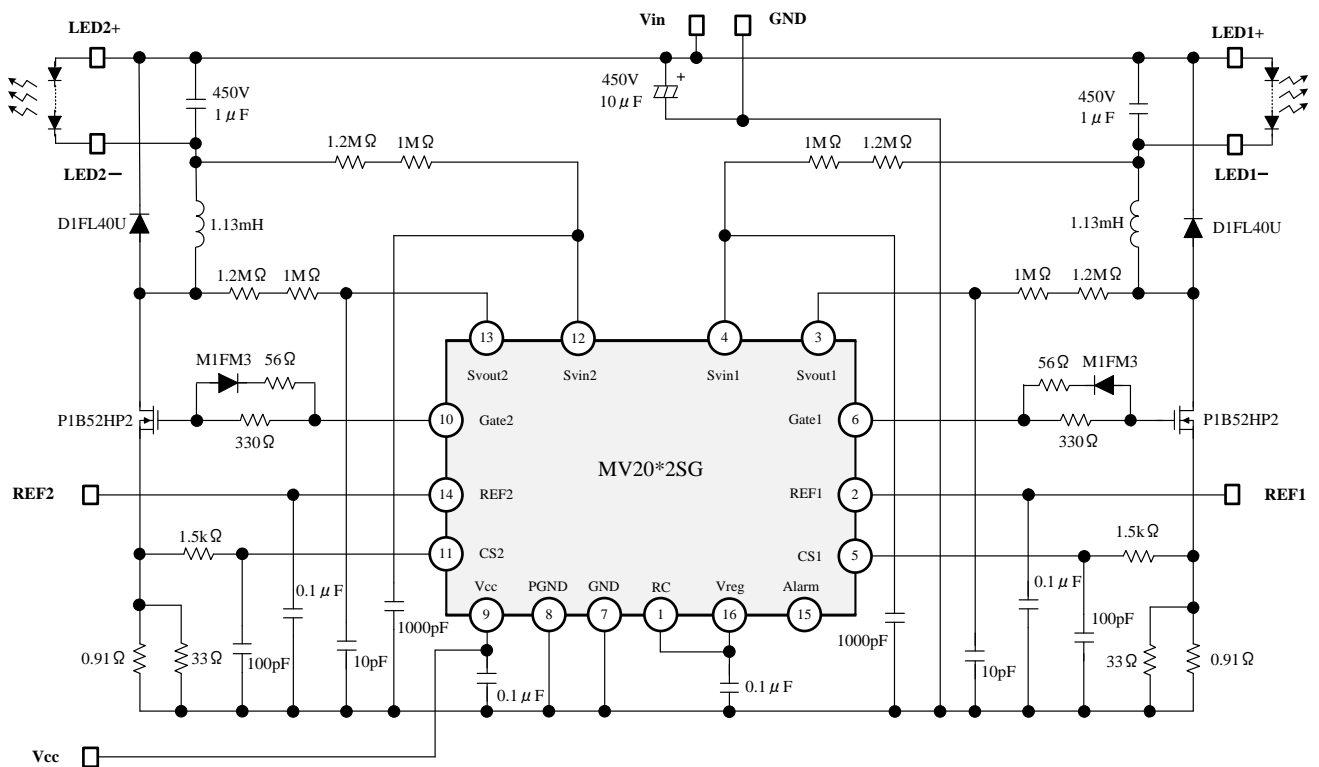
	Min	Typ	Max	Unit
入力電圧(DC)		270		V
CH1 出力電圧		140		V
CH2 出力電圧		140		V
CH1 出力電流	0.1 (※1)	300 (※2)	326 (※3)	mA
CH2 出力電流	0.1 (※1)	300 (※2)	326 (※3)	mA

(※1) $V_{in}=DC270V$ 、 $V_o=140V$ 設定、 $V_{REF} = 0V$ 時

(※2) $V_{REF} = 2.7V$ 時

(※3) $V_{REF} \geq 3.3V$ 時

◆ 回路図

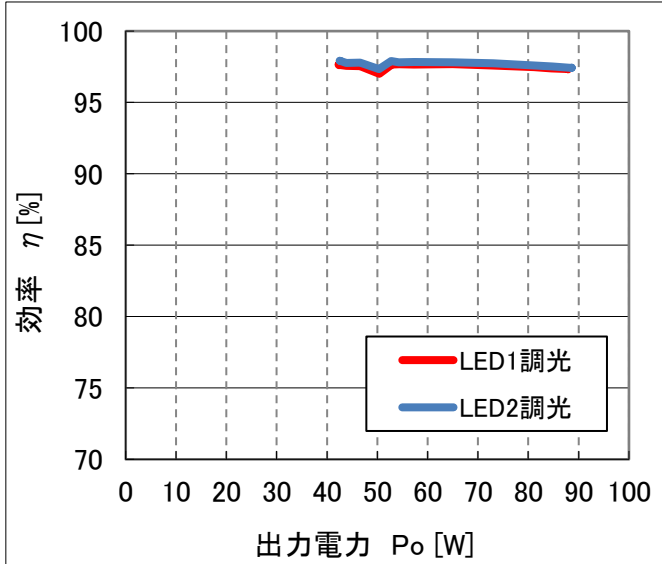


MV2002SG / MV2052SG

7.2 電源特性

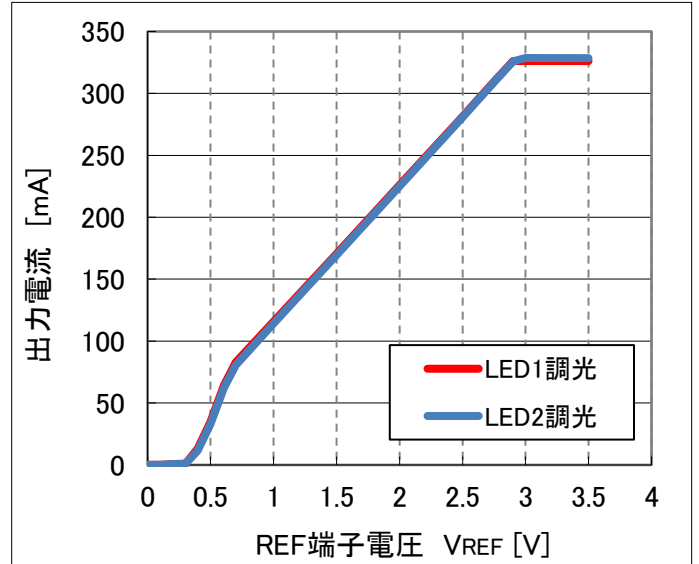
◆効率特性($V_{in}=DC270V$ 、 $V_{cc}=14V$ 、 $I_{reg}=0A$)

片側調光時(別 CH は $V_{REF}=2.7V$ 固定)



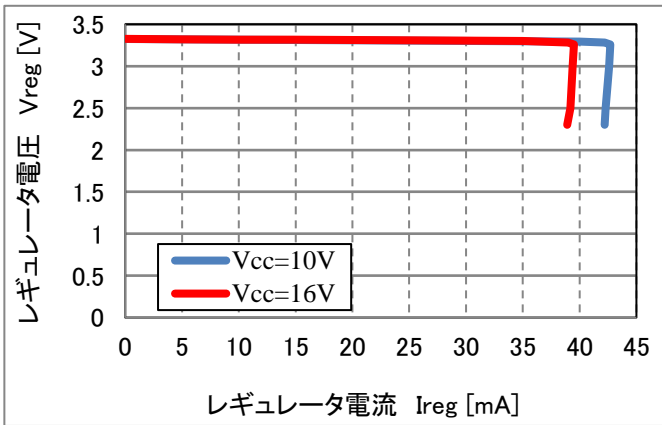
◆調光特性($V_{in}=DC270V$ 、 $V_{cc}=14V$ 、 $I_{reg}=0A$)

片側調光時(別 CH は $V_{REF}=2.7V$ 固定)

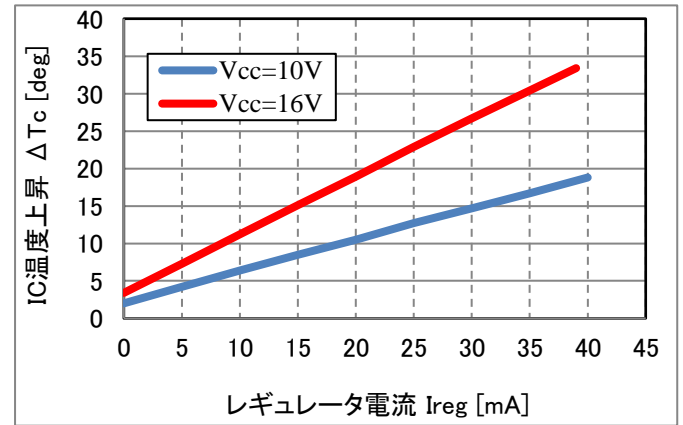


◆レギュレータ特性 ($T_a=25^\circ C$ 、 $V_{REF1}=V_{REF2}=0V$)

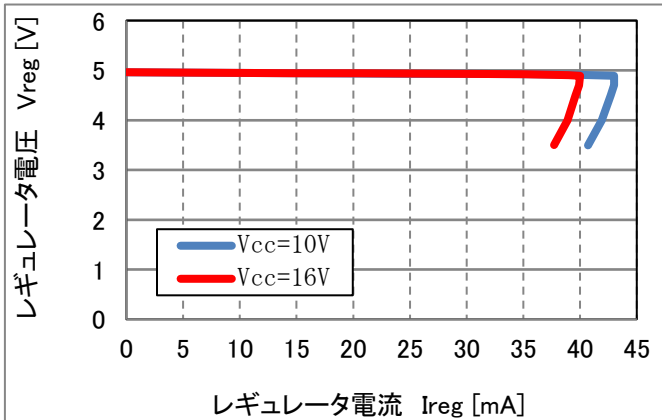
・MV2002SG レギュレータ電圧 vs レギュレータ電流



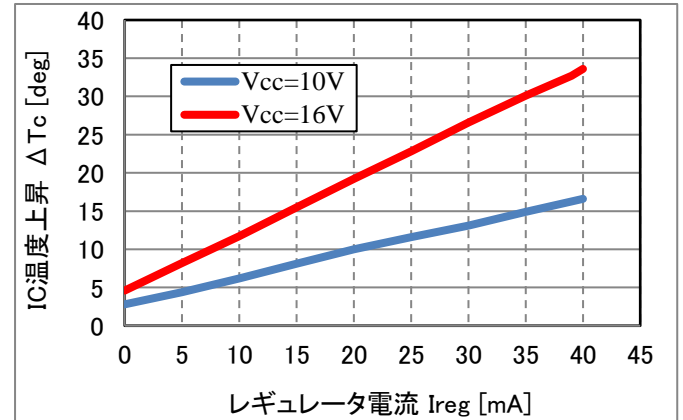
・MV2002SG IC 温度上昇 vs レギュレータ電流



・MV2052SG レギュレータ電圧 vs レギュレータ電流



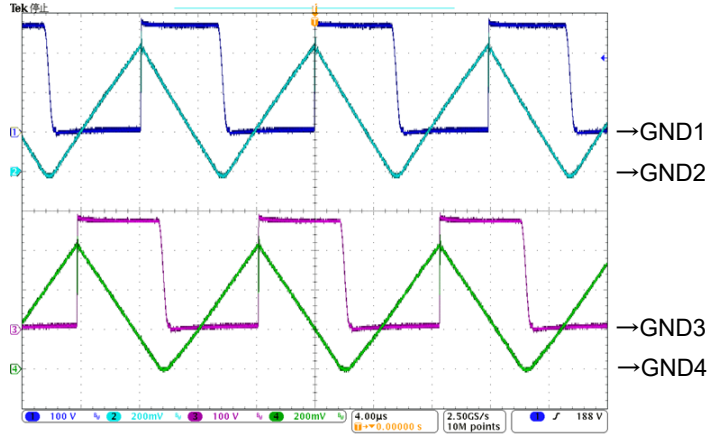
・MV2052SG IC 温度上昇 vs レギュレータ電流



MV2002SG / MV2052SG

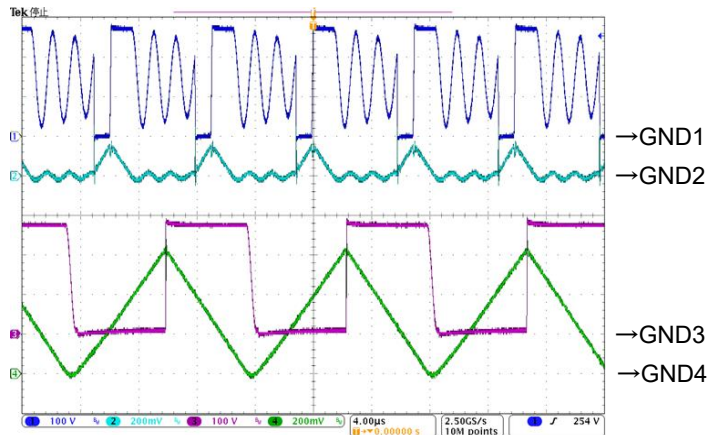
7.3 動作波形例

【A】周波数変調領域波形



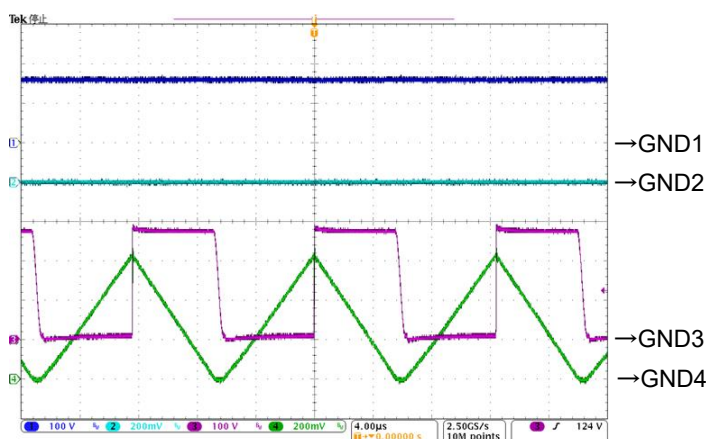
CH1	Vds1	100V/div
CH2	IL1	0.2A/div
CH3	Vds2	100V/div
CH4	IL2	0.2A/div
time	4 μ s/div	
Vin	DC270V	
Io1	300mA	
Io2	300mA	
CH1:調光 100%、CH2:調光 100%		

【B】オフ時間変調領域波形



CH1	Vds1	100V/div
CH2	IL1	0.2A/div
CH3	Vds2	100V/div
CH4	IL2	0.2A/div
time	4 μ s/div	
Vin	DC270V	
Io1	30mA	
Io2	300mA	
CH1:調光 10%、CH2:調光 100%		

【C】発振停止領域波形



CH1	Vds1	100V/div
CH2	IL1	0.2A/div
CH3	Vds2	100V/div
CH4	IL2	0.2A/div
time	4 μ s/div	
Vin	DC270V	
Io1	0.13mA	
Io2	300mA	
CH1:発振停止、CH2:調光 100%		

